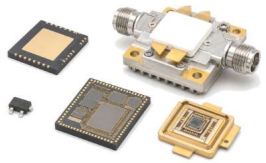
Catálogo de produtos

CIs de RF, MMICs e dispositivos semicondutores

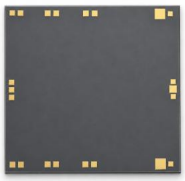
Blocos ativos de RF para amplificação, conversão, comutação, detecção, controle e síntese, organizados por função sem atribuir desempenho não comprovado a modelos específicos.



Produtos: 315

Revisão: 19 · Data da revisão: 2026-11-12

Amplificadores RF MMIC



LCI-PA-11500-18000-PS44p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 11500–18000 MHz

Amplificador de potência MMIC GaN em die nu para estágios de transmissão de 11,5 a 18 GHz. Opera em onda contínua ou pulsada e integra bloqueio CC nos dois caminhos de RF.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 11500; Máximo: 18000; Valor: 11500–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS42p5T

14000–18000 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 42 dBm (mínimo) / 42.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 35 % (mínimo). Dimensões do die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Mínimo: 42; Típico: 42.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14200-16800-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14200–16800 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14200; Máximo: 16800; Valor: 14200–16800; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14500-17200-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14500–17200 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14500; Máximo: 17200; Valor: 14500–17200; Unidade: MHz

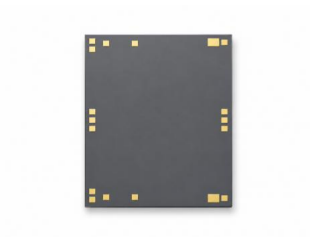
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; τ = 100 µs; D = 5%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-14500-PS45MIN

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13750–14500 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (mínimo); Ganho de potência: 20 dB (mínimo); PAE: 37 % (mínimo) / 38 % (típico). Dimensões do die: 2.8 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 14500; Valor: 13750–14500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.08 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-15250-PS46T

13750–15250 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 46 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 33 % (típico). Dimensões do die: 5 × 6 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 13750; Máximo: 15250; Valor: 13750–15250; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Típico: 46; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS48p5T

8000–12000 MHz Die amplificador de potência GaN MMIC de

Potência de saída saturada: 48 dBm (mínimo) / 48.5 dBm (típico); Ganho de potência: 23 dB (mínimo) / 23.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 44 % (típico). Dimensões do die: 4 × 5.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13800-18200-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13800–18200 MHz

PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (mínimo) / 21.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensões do die: 3.6 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13800; Máximo: 18200; Valor: 13800–18200; Unidade: MHz

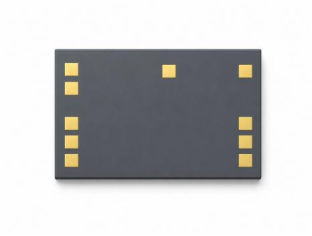
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS37p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14000–18000 MHz

PSAT: 37 dBm (mínimo) / 37.5 dBm (típico); Ganho de potência: 15 dB (mínimo) / 15.5 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 1.5 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 37; Típico: 37.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 15; Típico: 15.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12200-16000-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12200–16000 MHz

PSAT: 46 dBm (mínimo) / 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (mínimo) / 19.5 dB (típico); PAE: 33 % (típico). Dimensões do die: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12200; Máximo: 16000; Valor: 12200–16000; Unidade: MHz

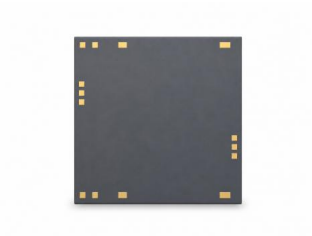
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-26000-40000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 26000–40000 MHz

Ganho de potência: 15 dB (típico); PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 23 % (típico). Dimensões do die: 3.4 × 3.4 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 26000; Máximo: 40000; Valor: 26000–40000; Unidade: MHz

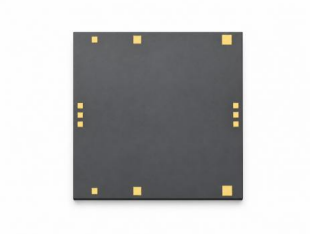
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidade: dB

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 15; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.8 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-31000-37000-PS41T

Die amplificador de potência MMIC de 31000–37000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 21 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 31000; Máximo: 37000; Valor: 31000–37000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-33000-37000-PS45T

Die amplificador de potência MMIC de 33000–37000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); PAE: 22 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 6.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 33000; Máximo: 37000; Valor: 33000–37000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.1 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-18000-40000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 18000–40000 MHz

PSAT: 40.5 dBm (típico); PAE: 15 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 21 dB (típico). Dimensões do die: 3.4 × 4.2 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 40000; Valor: 18000–40000; Unidade: MHz

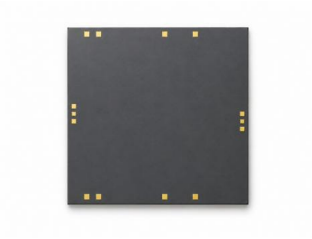
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 2.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS36T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 36 dBm (típico); PAE: 9 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 19 dB (típico). Dimensões do die: 5.1 × 5.1 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 36; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-27000-31000-PS43T

Die amplificador de potência de 27000–31000 MHz

PSAT: 43 dBm (típico); PAE: 28 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.26 × 4.8 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidade: MHz

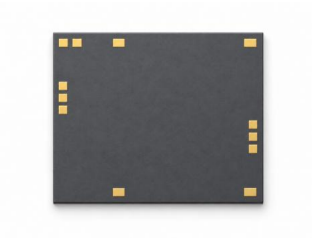
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-50000-63000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 50000–63000 MHz

PSAT: 37 dBm (típico); PAE: 20 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (típico). Dimensões do die: 2.9 × 2.4 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 50000; Máximo: 63000; Valor: 50000–63000; Unidade: MHz

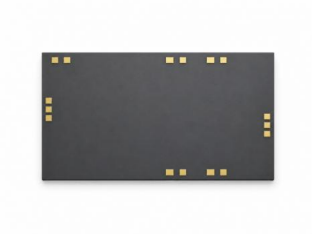
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.77 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS34T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34 dBm (típico); PAE: 10 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 19 dB (típico). Dimensões do die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

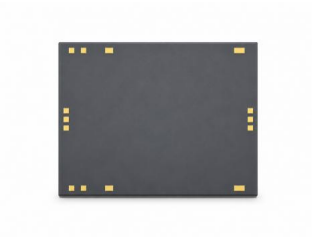
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 1.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-18000-26500-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 18000–26500 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); PAE: 26 % (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico). Dimensões do die: 4.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 18000; Máximo: 26500; Valor: 18000–26500; Unidade: MHz

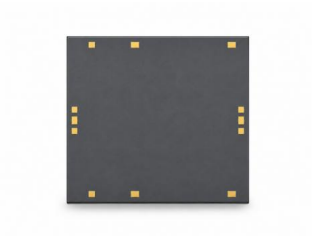
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.4; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-27000-31000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 27000–31000 MHz

PSAT: 42 dBm (típico); PAE: 30 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 23 dB (típico). Dimensões do die: 3.26 × 3 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 27000; Máximo: 31000; Valor: 27000–31000; Unidade: MHz

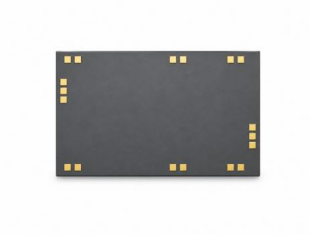
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 0.5 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-43000-PS30T

Die amplificador de potência de 15000–43000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 18 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (mínimo) / 20 dB (típico) / 22 dB (máximo). Dimensões do die: 3.94 × 2.48 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 43000; Valor: 15000–43000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Mínimo: 18; Típico: 20; Máximo: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±2; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 29.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 0.9 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS26p5T

Die amplificador de potência de 92000–96000 MHz

PSAT: 26.5 dBm (típico); PAE: 12 % (típico) / 13 % (máximo); Ganho de pequenos sinais: 18 dB (típico). Dimensões do die: 3.25 × 1.15 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 26.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +18 V; Id = 0.11 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–17000 MHz

PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensões do die: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12700-14500-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12700–14500 MHz

pulsada: PSAT: 46.8 dBm (mínimo) / 47 dBm (típico); Ganho de potência: 18.8 dB (mínimo) / 19 dB (típico); PAE: 37 % (típico). Dimensões do die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12700; Máximo: 14500; Valor: 12700–14500; Unidade: MHz

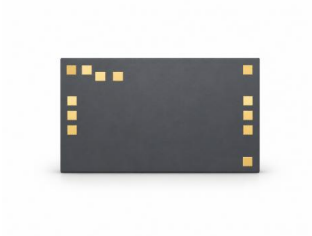
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.8; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.8; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.96 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-18000-PS38T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–18000 MHz

pulsada: PSAT: 38 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); PAE: 40 % (típico). Dimensões do die: 2.3 × 1.35 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18000; Valor: 15000–18000; Unidade: MHz

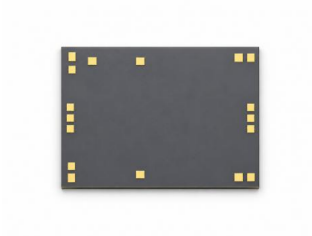
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 38; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13000-15000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13000–15000 MHz

pulsada: PSAT: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (mínimo) / 37 % (típico). Dimensões do die: 2.8 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13000; Máximo: 15000; Valor: 13000–15000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.35; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-12000-15000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 12000–15000 MHz

pulsada: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (mínimo) / 22.5 dB (típico); PAE: 30 % (mínimo) / 34 % (típico). Dimensões do die: 4.1 × 5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 15000; Valor: 12000–15000; Unidade: MHz

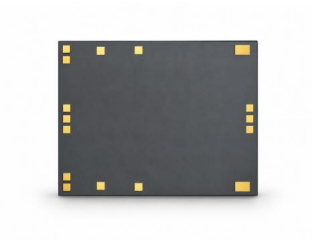
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG24T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–17000 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); PAE: 43 % (típico). Dimensões do die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 17000; Valor: 15000–17000; Unidade: MHz

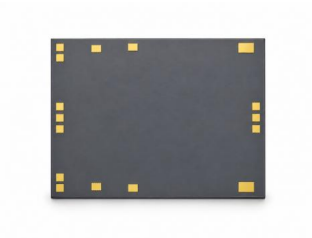
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-14000-18000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 14000–18000 MHz

pulsada: PSAT: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); PAE: 41 % (típico). Dimensões do die: 3.1 × 2.45 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-15000-18500-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 15000–18500 MHz

pulsada: PSAT: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.34 × 4.95 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 15000; Máximo: 18500; Valor: 15000–18500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13750-15350-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 13750–15350 MHz

pulsada: PSAT: 47 dBm (mínimo) / 48 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (mínimo) / 20 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13750; Máximo: 15350; Valor: 13750–15350; Unidade: MHz

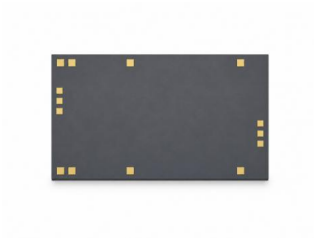
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-34000-64000-PS30T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 34000–64000 MHz

PSAT: 30 dBm (típico); PAE: 17 % (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico). Dimensões do die: 3.9 × 2.3 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 34000; Máximo: 64000; Valor: 34000–64000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 19; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 27; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 30; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +4 V; Id = 0.81 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-92000-96000-PS34p5T

Die amplificador de potência MMIC de 92000–96000 MHz

PSAT: 34.5 dBm (típico); PAE: 14 % (típico); Ganho de pequenos sinais: 22 dB (típico). Dimensões do die: 4.5 × 2.6 × 0.05 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 92000; Máximo: 96000; Valor: 92000–96000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: S21; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔS21; Típico: ±1; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 34.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +15 V; Id = 0.28 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG28T-M

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.7 dB (típico) / 0.75 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 26.5 dB (mínimo) / 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do die: 1.4 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 26.5; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T

14000–15000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensões do die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-14000-15000-NF1p1T-M

14000–15000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 5 dBm (típico). Dimensões do die: 1.8 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 15000; Valor: 14000–15000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T

800–4000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potência de saída na compressão de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensões do die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-4000-NF0p4T-M

800–4000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32 dB (típico) (Vd = +5 V); Potência de saída na compressão de 1 dB: 15 dBm (típico) (Vd = +5 V). Dimensões do die: 1.8 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 4000; Valor: 800–4000; Unidade: MHz

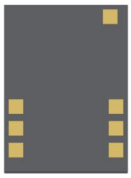
Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 15; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 32; Valor: Vd = +5 V; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-30-600-NF0p6T

30–600 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 32.3 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.85 × 1.15 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 30; Máximo: 600; Valor: 30–600; Unidade: MHz

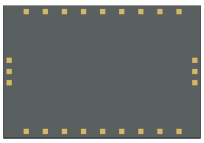
Ganho de pequenos sinais: Típico: 32.3; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

TA = +25 °C; Vd = +4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-75000-110000-NF3p3MAX

75000–110000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 2.8 dB (típico) (f = 90000 MHz); Figura de ruído: 3.3 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 25 dB (típico) (f = 75000–90000 MHz); Ganho de pequenos sinais: 22 dB (típico) (f = 90000–110000 MHz). Dimensões do die: 2 × 3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 75000; Máximo: 110000; Valor: 75000–110000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 25; Unidade: dB; Notas: f = 75000–90000 MHz

Ganho de pequenos sinais: Típico: 22; Unidade: dB; Notas: f = 90000–110000 MHz

Perda de retorno de entrada: Típico: 6; Unidade: dB

TA = +25 °C; VD1–VD4 = +1 V; VG1–VG4 = 0 V; IDtotal = 0.033 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-17000-22000-NF1p3T

17000–22000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC

Figura de ruído: 1.3 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 26 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 4 dBm (típico). Dimensões do die: 1.5 × 0.75 × 0.07 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 17000; Máximo: 22000; Valor: 17000–22000; Unidade: MHz

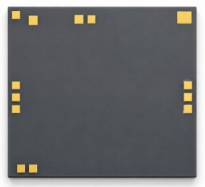
Ganho de pequenos sinais: Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Típico: ±0.5; Unidade: dB

Figura de ruído: Típico: 1.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS31T

Die amplificador de potência GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsada: PSAT: 30.5 dBm (mínimo) / 31 dBm (típico); Ganho de potência: 35.5 dB (mínimo) / 36 dB (típico); PAE: 45 % (mínimo) / 48 % (típico). Dimensões do die em planta: 2.5 × 2.262 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30.5; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 35.5; Típico: 36; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.8 V; Pin = -5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS34p5T

Die amplificador de potência GaAs MMIC de 2700–3900 MHz

pulsada: PSAT: 34 dBm (mínimo) / 34.5 dBm (típico); Ganho de potência: 29 dB (mínimo) / 29.5 dB (típico); PAE: 47 % (mínimo) / 49 % (típico). Dimensões do die em planta: 2.2 × 3.092 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

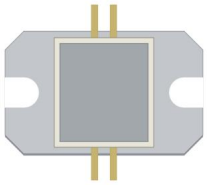
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 34; Típico: 34.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 29; Típico: 29.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +8 V; Vg = -0.7 V; Pin = 5 dBm; τ = 100 µs; D = 10%; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-200-2200-PS41T

200–2200 MHz Amplificador de potência GaN MMIC em encapsulamento metal-cerâmico

Potência de saída saturada: 39.5 dBm (mínimo) / 41 dBm (típico); Ganho de potência: 23.5 dB (mínimo) / 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (mínimo) / 50 % (típico).

Frequência de operação: Mínimo: 200; Máximo: 2200; Valor: 200–2200; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Mínimo: 39.5; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = +16 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T

8000–12000 MHz Amplificador de baixo ruído em QFN

Figura de ruído: 0.9 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do encapsulamento: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 28; Unidade: dB

Figura de ruído: Típico: 0.9; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG28T-M

8000–12000 MHz Amplificador de baixo ruído em QFN

Figura de ruído: 0.9 dB (típico); Ganho de pequenos sinais: 28 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB: 10 dBm (típico). Dimensões do encapsulamento: 2.5 × 2.5 × 0.75 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

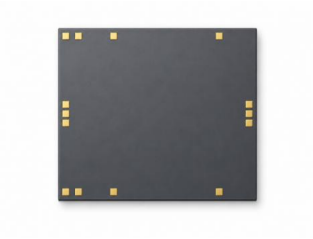
Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Típico: 28; Unidade: dB

Figura de ruído: Típico: 0.9; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Pin = -35 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 20 % (típico); Dimensões do die: 3.9 × 3.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 16.2; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS29T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 29 dBm (típico); Ganho de potência: 14 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 15 % (típico); Dimensões do die: 1.95 × 1.35 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 14; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.5; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 29; Unidade: dBm

TA = +25 °C; Vd = +28 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganho de potência 20.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS40p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 40.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 2.8 × 2.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

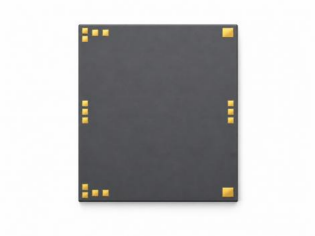
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39.5; Típico: 40.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.5; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS45p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 45.8 dBm (típico); Ganho de potência: 18.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 42 % (típico); Dimensões do die: 3.17 × 3.58 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

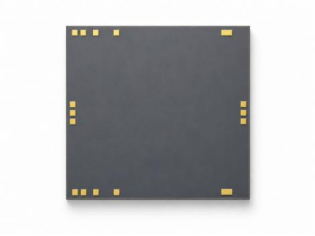
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.8; Típico: 45.8; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17.8; Típico: 18.8; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 27 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-10000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–10000 MHz

4000–10000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 4.1 × 3.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 10000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.8; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 15.8; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-6200-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–6200 MHz

2500–6200 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 6200; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8500-10500-PS47p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 47.8 dBm (típico); Ganho de potência: 21.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 47 % (típico); Dimensões do die: 4 × 5.1 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidade: MHz

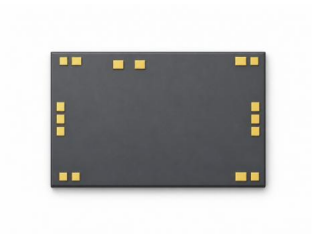
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.8; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 21.8; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS42T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 43 % (típico); Dimensões do die: 3.04 × 1.91 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.2; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.2; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18000-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganho de potência 12 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

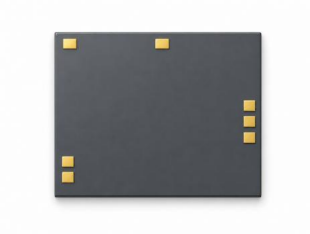
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 12; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS33p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 33.5 dBm (típico); Ganho de potência: 12 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 20 % (típico); Dimensões do die: 2.1 × 1.7 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

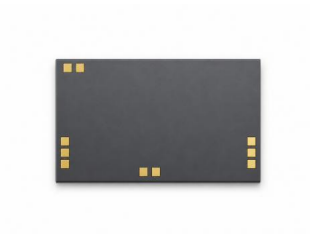
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 33; Típico: 33.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 11; Típico: 12; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18000-PS35T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18000 MHz

2000–18000 MHz; PSAT 35 dBm (típico); Ganho de potência 7 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

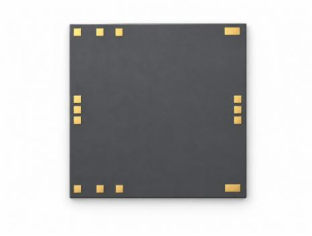
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 7; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 9200–10400 MHz

9200–10400 MHz; Potência de saída saturada: 46.2 dBm (típico); Ganho de potência: 24.2 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.03 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9200; Máximo: 10400; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.2; Máximo: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.2; Máximo: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7500-10500-PS49T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7500–10500 MHz

7500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 49 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.7 × 6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7500; Máximo: 10500; Unidade: MHz

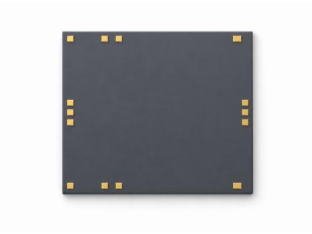
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 48.6; Típico: 49; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.6; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7000-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 23 % (típico); Dimensões do die: 4.52 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS49p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 49.5 dBm (típico); Ganho de potência: 26.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 5.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

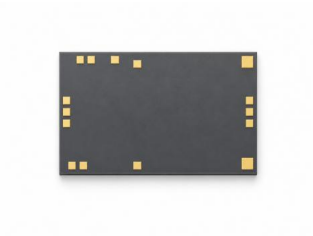
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 49; Típico: 49.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 40 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 23 % (típico); Dimensões do die: 3 × 1.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

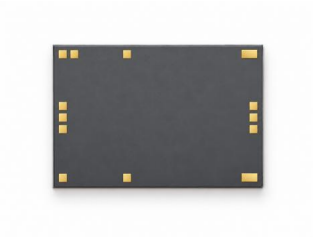
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-18000-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–18000 MHz

10000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

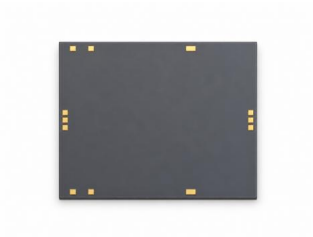
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.9; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 18.9; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-950-1250-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 950–1250 MHz

950–1250 MHz; Potência de saída saturada: 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico); Dimensões do die: 4.35 × 3.43 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 950; Máximo: 1250; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–6000 MHz

5000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 47.5 dBm (típico); Ganho de potência: 24.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 53 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

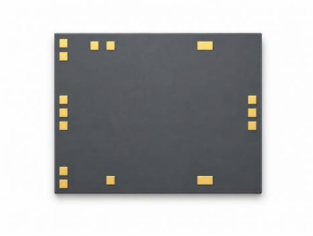
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 22.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 2.7 × 2.08 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS39T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 39 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 43 % (típico); Dimensões do die: 2.3 × 1.15 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38; Típico: 39; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.7; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8500-10500-PS52T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8500–10500 MHz

8500–10500 MHz; Potência de saída saturada: 52 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 52; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS47p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 47.5 dBm (típico); Ganho de potência 17.5 dB (típico); PAE 40% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

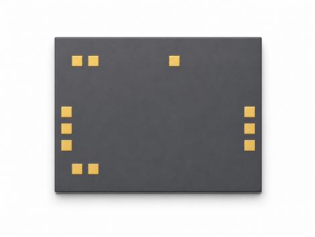
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4000–8000 MHz

4000–8000 MHz; PSAT 37 dBm (típico); Ganho de potência 20 dB (típico); PAE 35% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

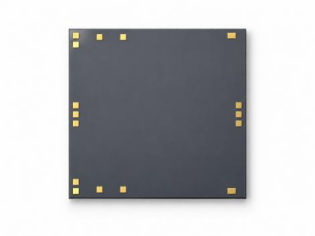
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 36.5; Típico: 37; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19.5; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

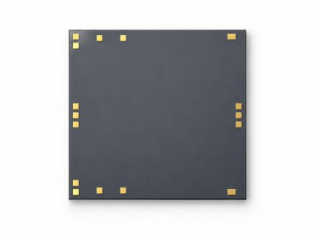
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS47T-B

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–12000 MHz

8000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 45 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 3.6 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

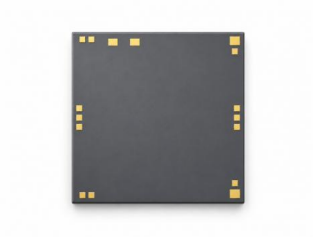
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3600-5000-PS44p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3600–5000 MHz

3600–5000 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 23.5 dB (típico); PAE 43% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3600; Máximo: 5000; Unidade: MHz

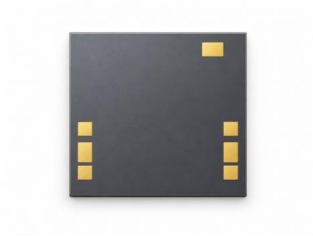
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23; Típico: 23.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-13000-PS25T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 25 dBm (típico); Ganho de potência: 10 dB (típico); Dimensões do die: 1.3 × 1.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

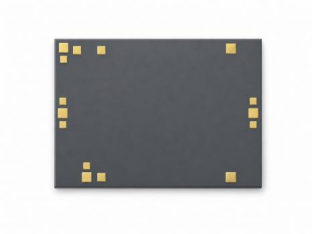
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 25; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 10; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 15 dBm; °CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-13000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5000–13000 MHz

5000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 42 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 35 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 2.26 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4200-7000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4200–7000 MHz

4200–7000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganho de potência 22 dB (típico); PAE 45% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4200; Máximo: 7000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.8; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 21.8; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 20.5 dB (típico); PAE 35% (típico); CW; Vd = +24 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

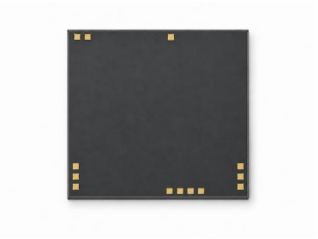
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 20; Típico: 20.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +24 V; Vg = -2.4 V; Pin = 25 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-200-2200-PS41p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 200–2200 MHz

Die GaN sobre SiC para 200–2200 MHz, com potência saturada típica de 41.5 dBm, ganho de potência típico de 25.5 dB e dimensões de 3.00 × 3.00 × 0.10 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 2200; Unidade: MHz

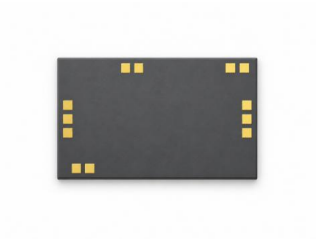
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41.0; Típico: 41.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.0; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.0; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = −2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3400-5600-PS40T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3400–5600 MHz

3400–5600 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganho de potência 17 dB (típico); PAE 46% (típico); CW.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3400; Máximo: 5600; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 39; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 16; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5800-6800-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 5800–6800 MHz

5800–6800 MHz; Potência de saída saturada: 47 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 46 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 5.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5800; Máximo: 6800; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 25.5 dB (típico); PAE 58% (típico); CW.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidade: MHz

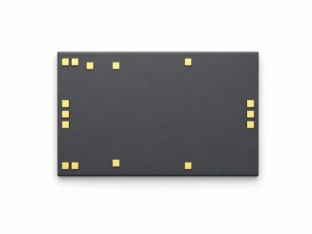
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6700-7400-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6700–7400 MHz

6700–7400 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 55 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6700; Máximo: 7400; Unidade: MHz

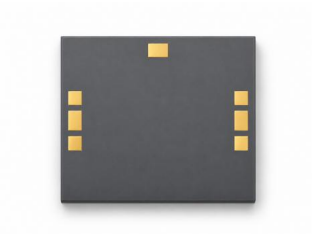
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS27T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 27 dBm (típico); Ganho de potência: 9 dB (típico); Dimensões do die: 1.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

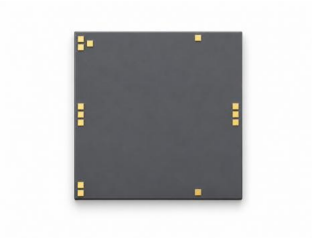
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 26; Típico: 27; Máximo: 29; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 8; Típico: 9; Máximo: 11; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Pin = 18 dBm; °CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-8000-PS42T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–8000 MHz

2000–8000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganho de potência 15 dB (típico); PAE 30% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Unidade: MHz

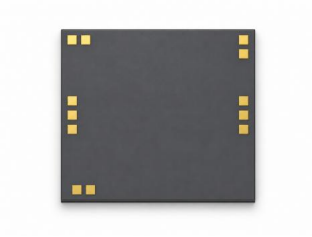
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 14; Típico: 15; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-3700-PS41p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–3700 MHz

2500–3700 MHz; PSAT 41.5 dBm (típico); Ganho de potência 22.5 dB (típico); PAE 50% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 3700; Unidade: MHz

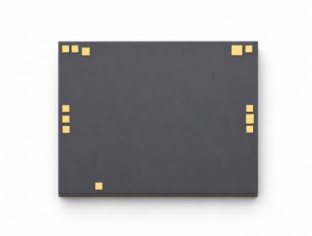
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 41; Típico: 41.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 22; Típico: 22.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2600-3300-PS45p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2600–3300 MHz

2600–3300 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 25.5 dB (típico); PAE 60% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3300; Unidade: MHz

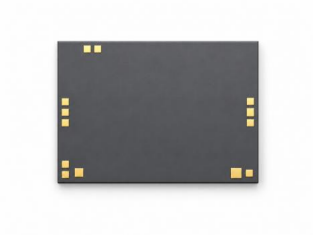
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25; Típico: 25.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2400-3800-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2400–3800 MHz

2400–3800 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganho de potência 27.5 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2400; Máximo: 3800; Unidade: MHz

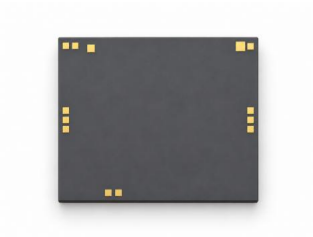
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 27; Típico: 27.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-4000-PS47T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2500–4000 MHz

2500–4000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganho de potência 26 dB (típico); PAE 52% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 4000; Unidade: MHz

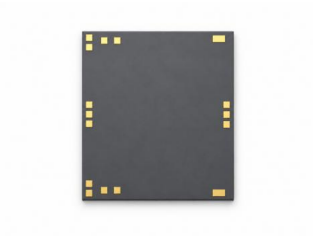
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46.2; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.2; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; Pin = 21 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-9400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 31 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidade: MHz

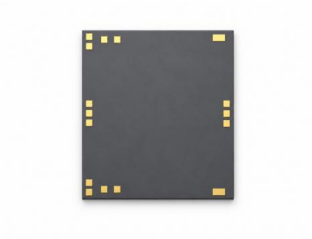
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-9400-PS45T-A

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–9400 MHz

8000–9400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 31 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3 × 3.2 × 0.1 mm. Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 9400; Unidade: MHz

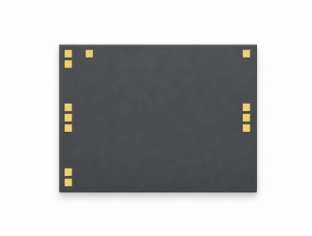
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1200-1600-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1200–1600 MHz

1200–1600 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 17 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 60 % (típico); Dimensões do die: 2.7 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 28 % (típico); Dimensões do die: 4 × 5.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

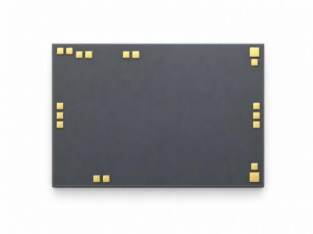
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Máximo: 47.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4400-6500-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 4400–6500 MHz

4400–6500 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 27 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 47 % (típico); Dimensões do die: 3.51 × 2.44 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4400; Máximo: 6500; Unidade: MHz

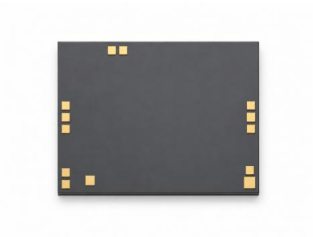
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43.5; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.5; Típico: 27; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3500 MHz

2700–3500 MHz; PSAT 43.5 dBm (típico); Ganho de potência 26.5 dB (típico); PAE 61% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Unidade: MHz

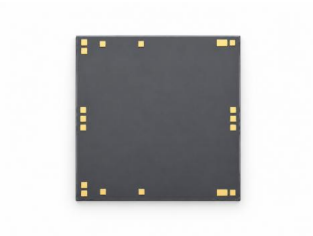
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 43; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10800-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10800–13000 MHz

10800–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 3.4 × 3.52 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10800; Máximo: 13000; Unidade: MHz

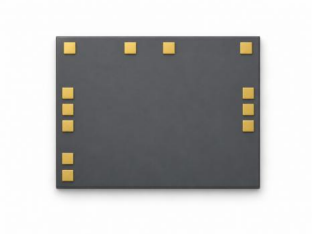
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9000-11000-PS37T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 9000–11000 MHz

9000–11000 MHz; Potência de saída saturada: 37 dBm (típico); Ganho de potência: 22 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 38 % (típico); Dimensões do die: 2.04 × 1.54 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 11000; Unidade: MHz

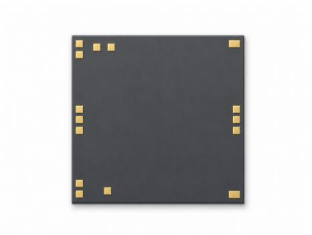
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 37; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-8400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–8400 MHz

8000–8400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 23 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 55 % (típico); Dimensões do die: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 8400; Unidade: MHz

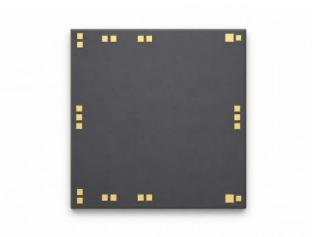
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3700-5000-PS45p2T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 3700–5000 MHz

3700–5000 MHz; PSAT 45.2 dBm (típico); Ganho de potência 27 dB (típico); PAE 48% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Unidade: MHz

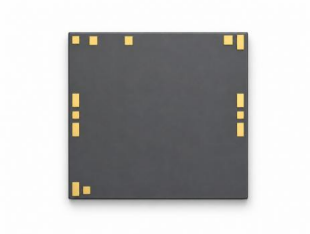
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 45; Típico: 45.2; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 26.8; Típico: 27; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 18 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS43T-D

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–6000 MHz

2000–6000 MHz; Potência de saída saturada: 43 dBm (típico); Ganho de potência: 26.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 50 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 2.9 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Unidade: MHz

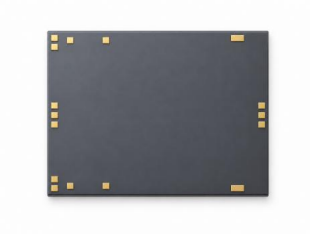
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 42.5; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 25.5; Típico: 26.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-18000-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–18000 MHz

6000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 4 × 3.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS44T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 44 dBm (típico); Ganho de potência: 19 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

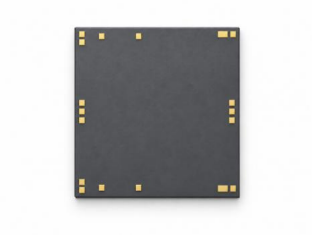
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 44; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 19; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

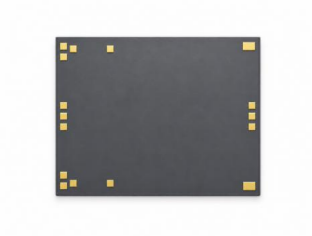
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-18000-PS43p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 8000–18000 MHz

8000–18000 MHz; Potência de saída saturada: 43.5 dBm (típico); Ganho de potência: 19.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 30 % (típico); Dimensões do die: 3.2 × 2.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Unidade: MHz

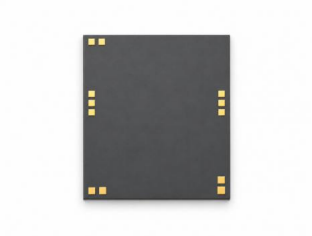
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 19.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-2800-PS41T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–2800 MHz

2000–2800 MHz; Potência de saída saturada: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 56 % (típico); Dimensões do die: 2.4 × 2.7 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 2800; Unidade: MHz

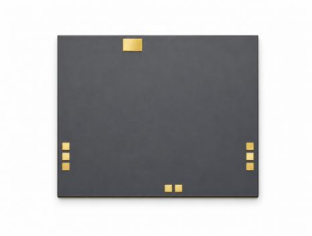
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40.7; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.7; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: 1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-300-6000-PS40p8T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potência de saída saturada: 40.8 dBm (típico); Ganho de potência: 12.8 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 2.95 × 2.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 40; Típico: 40.8; Máximo: 41.6; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 12; Típico: 12.8; Máximo: 13.6; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.8; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-18500-PS43T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2000–18500 MHz

2000–18500 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganho de potência 13 dB (típico); PAE 20% (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18500; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 13; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1950-4050-PS46p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1950–4050 MHz

1950–4050 MHz; Potência de saída saturada: 46.5 dBm (típico); Ganho de potência: 24.5 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 52 % (típico); Dimensões do die: 3.56 × 3.78 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1950; Máximo: 4050; Unidade: MHz

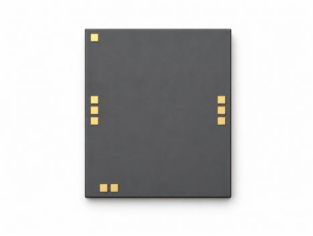
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24; Típico: 24.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-300-6000-PS30T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 300–6000 MHz

300–6000 MHz; Potência de saída saturada: 30 dBm (típico); Ganho de potência: 15 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 15 % (típico); Dimensões do die: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 28; Típico: 30; Máximo: 32.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 13; Típico: 15; Máximo: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±2.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3900-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 2700–3900 MHz

2700–3900 MHz; PSAT 48 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 56% (típico); τ = 100 µs; D = 10%.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47.6; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 23.6; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.6; Unidade: dB

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS30p5T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 30.5 dBm (típico); Ganho de potência: 30 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 22 % (típico); Dimensões do die: 2.22 × 1.16 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 30; Típico: 30.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 30; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10000-13000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 10000–13000 MHz

10000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 20 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 37 % (típico); Dimensões do die: 3.4 × 5.74 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

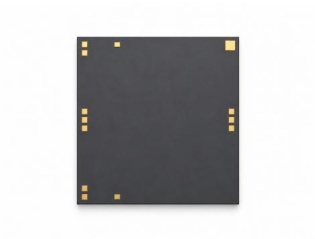
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 47; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 19; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 2.2 A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1200-2400-PS45T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 1200–2400 MHz

1200–2400 MHz; Potência de saída saturada: 45 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 53 % (típico); Dimensões do die: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 2400; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 44.5; Típico: 45; Máximo: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 24.5; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-12000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 6000–12000 MHz

6000–12000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.85 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7000-13000-PS48T

Die amplificador de potência GaN MMIC de 7000–13000 MHz

7000–13000 MHz; Potência de saída saturada: 48 dBm (típico); Ganho de potência: 24 dB (típico); Eficiência de potência adicionada: 40 % (típico); Dimensões do die: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Unidade: MHz

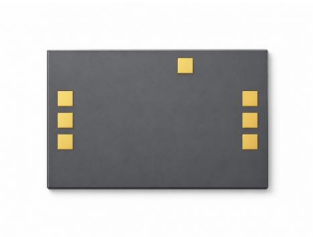
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-5000-6000-NF0p6T

5000–6000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

5000–6000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); P1dB 6 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

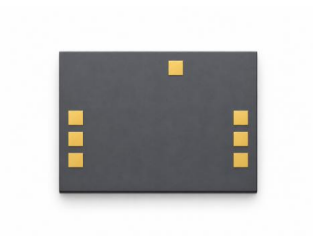
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-13000-NF0p9T

7000–13000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.9 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 0.9 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-13000-NF1T

7000–13000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1 dB (típico)

7000–13000 MHz; NF 1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

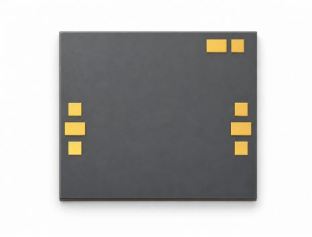
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 6; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 28; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

2000–6000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.8 dB (típico)

2000–6000 MHz; NF 0.8 dB (típico); Ganho de pequenos sinais ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

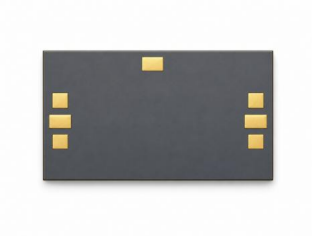
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 10; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 29; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-6000-18000-NF1p2T

6000–18000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–18000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

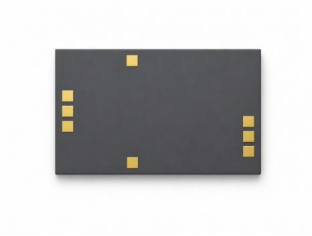
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 22; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T

24000–40000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 2.5 dB (típico)

24000–40000 MHz; NF 2.5 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); P1dB ≥ 11 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 40000; Valor: 24000–40000; Unidade: MHz

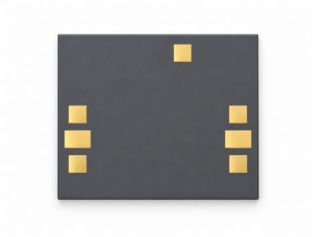
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 11; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p7T-SG26T

8000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.7 dB (típico)

8000–12000 MHz; NF 0.7 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB 8 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 7; Típico: 8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Mínimo: 25; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Máximo: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-20000-NF2T

2000–20000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 2 dB (típico)

2000–20000 MHz; NF 2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 17 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 20000; Valor: 2000–20000; Unidade: MHz

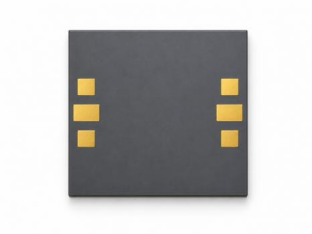
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-100-2000-NF1p1T

100–2000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.1 dB (típico)

100–2000 MHz; NF 1.1 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 17.5 dB (típico); P1dB 19.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 2000; Valor: 100–2000; Unidade: MHz

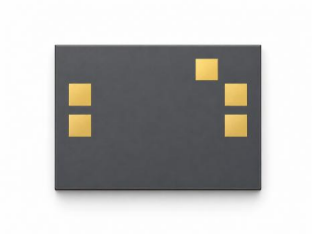
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-800-2000-NF0p45T

800–2000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico)

800–2000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); P1dB 20.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz

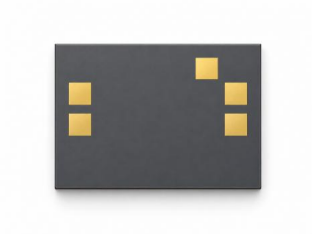
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-200-600-NF0p4T

200–600 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.4 dB (típico)

200–600 MHz; NF 0.4 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); P1dB 21 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 200; Máximo: 600; Valor: 200–600; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 22.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB14T

2000–5000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 30 dB (típico); P1dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 14; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

7000–9000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB

7000–9000 MHz; NF 0.6 dB; Ganho de pequenos sinais 31 dB (típico); P1dB 15 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 9000; Valor: 7000–9000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 31; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-6000-20000-NF1p2T

6000–20000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.2 dB (típico)

6000–20000 MHz; NF 1.2 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB -2 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 20000; Valor: 6000–20000; Unidade: MHz

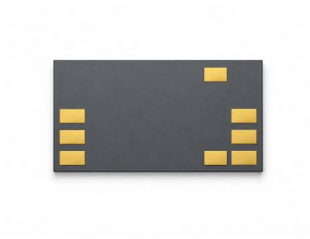
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: -4; Típico: -2; Máximo: 0; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-4000-12000-NF0p6T

4000–12000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.6 dB (típico)

4000–12000 MHz; NF 0.6 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 34.5 dB (típico); P1dB 7 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 12000; Valor: 4000–12000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Mínimo: 6.5; Típico: 7; Máximo: 8.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 34.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p45T-P1DB11T

2000–5000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 0.45 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico)

2000–5000 MHz; NF 0.45 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 30 dB (típico); P1dB 11 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz

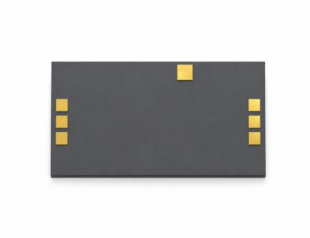
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 11; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 12; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 30; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T

32000–52000 MHz Die amplificador de baixo ruído GaAs MMIC — NF 1.8 dB (típico)

32000–52000 MHz; NF 1.8 dB (típico); Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); P1dB 5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 52000; Valor: 32000–52000; Unidade: MHz

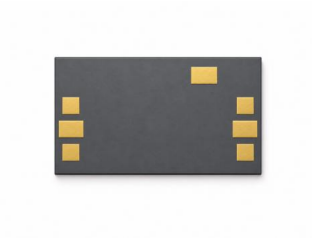
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-8000-12000-P1DB16T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

8000–12000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 24 dB (típico); NF 1.7 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

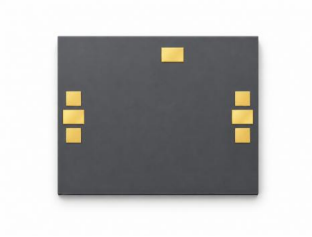
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 24; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-700-5000-P1DB19T

700–5000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 19 dBm (típico)

700–5000 MHz; P1dB 19 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 14 dB (típico); NF 2.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 5000; Valor: 700–5000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 19; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 14; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23p5T

2700–3500 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 28 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

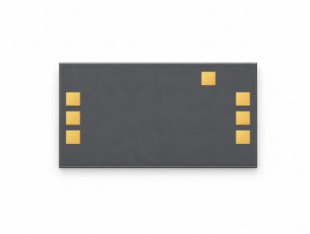
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 25; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 28; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-D

14000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

14000–18000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 19 dB (típico); NF 5.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

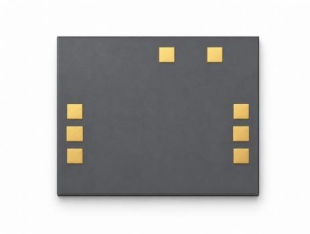
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 19; Máximo: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-5000-20000-P1DB20T

5000–20000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 20 dBm (típico)

5000–20000 MHz; P1dB 20 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 6.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 20000; Valor: 5000–20000; Unidade: MHz

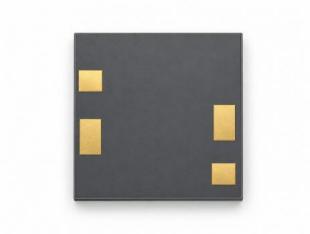
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 20; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 21; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB22p8T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 22.8 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 22.8 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 1.8 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz

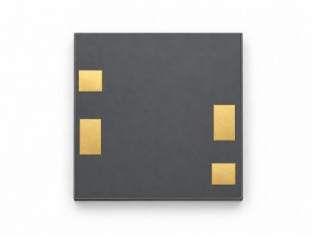
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 22.8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-DC-6000-P1DB21T

DC–6000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 21 dBm (típico)

DC–6000 MHz; P1dB 21 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 20 dB (típico); NF 1 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz

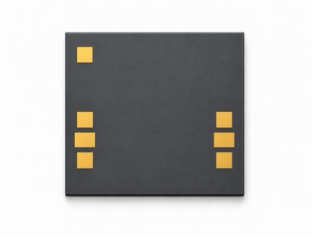
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 21; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±1; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T

800–2000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 15 dBm (típico)

800–2000 MHz; P1dB 15 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 17 dB (típico); NF 1.4 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz

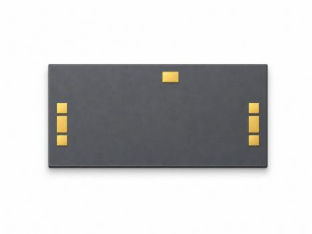
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 15; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidade: dB

Planicidade do ganho de pequenos sinais: Símbolo: ΔGain; Típico: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23p5T

2000–7000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23.5 dBm (típico)

2000–7000 MHz; P1dB 23.5 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 7000; Valor: 2000–7000; Unidade: MHz

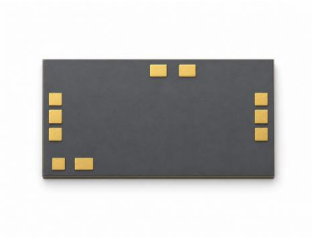
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23.5; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 24.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-8000-12000-PS28T

8000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 28 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 28 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

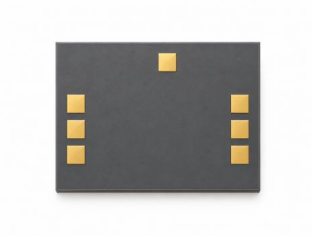
Potência de saída saturada: Mínimo: 27.8; Típico: 28; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 19; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = -0.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-4000-9000-P1DB17T

4000–9000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 17 dBm (típico)

4000–9000 MHz; P1dB 17 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 13 dB (típico); NF 3.5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 9000; Valor: 4000–9000; Unidade: MHz

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 17; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 18; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 13; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2000-18000-P1DB16T

2000–18000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 16 dBm (típico)

2000–18000 MHz; P1dB 16 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico); NF 3 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz

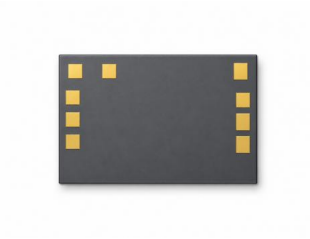
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 16; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 17; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-6000-12000-P1DB23T

6000–12000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — P1dB 23 dBm (típico)

6000–12000 MHz; P1dB 23 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 23 dB (típico); NF 5 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Valor: 6000–12000; Unidade: MHz

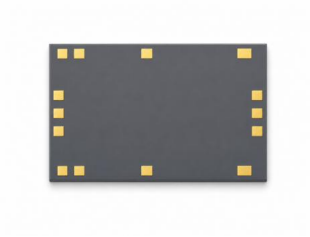
Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P1dB; Típico: 23; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Valor: 23.8; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 23; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-24000-31000-PS25T

24000–31000 MHz Die amplificador GaAs MMIC — PSAT 25 dBm (típico)

24000–31000 MHz; PSAT 25 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 22 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 24000; Máximo: 31000; Valor: 24000–31000; Unidade: MHz

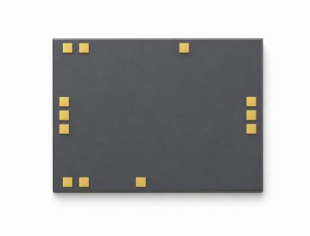
Ganho de pequenos sinais: Típico: 22; Unidade: dB

Potência de saída saturada: Típico: 25; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 20; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Id = 160 mA

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB24T

8000–18000 MHz Die amplificador bidirecional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico)

8000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 24 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 21 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Valor: 8000–18000; Unidade: MHz

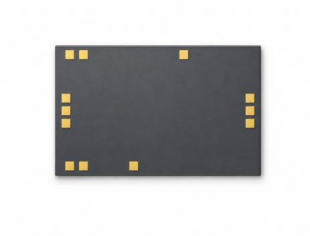
Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Típico: 24; Unidade: dBm

Potência de saída saturada (Rx): Típico: 24.5; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 21; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB21T

6000–18000 MHz Die amplificador bidirecional GaAs MMIC — Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico)

6000–18000 MHz; Rx / Tx: Rx / Tx P1dB 21 dBm (típico); Ganho de pequenos sinais 19 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

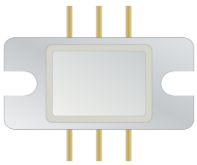
Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Típico: 21; Unidade: dBm

Potência de saída saturada (Rx): Típico: 22; Unidade: dBm

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 19; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS40T

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 40 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 40 dBm (típico); Ganho de potência 22 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

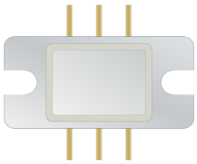
Potência de saída saturada: Mínimo: 39.5; Típico: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 21.5; Típico: 22; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 32; Típico: 38; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 18 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-7500-10500-PS48T

7500–10500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 48 dBm (típico)

7500–10500 MHz; PSAT 48 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7500; Máximo: 10500; Valor: 7500–10500; Unidade: MHz

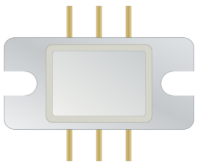
Potência de saída saturada: Mínimo: 47.5; Típico: 48; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23.5; Típico: 24; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 32; Típico: 40; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-8500-PS41T

2000–8500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 41 dBm (típico)

2000–8500 MHz; PSAT 41 dBm (típico); Ganho de potência 15 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8500; Valor: 2000–8500; Unidade: MHz

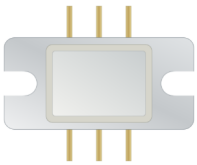
Potência de saída saturada: Mínimo: 40.3; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 14.3; Típico: 15; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 25; Típico: 35; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-6200-PS44p5T

2500–6200 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

2500–6200 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 16.5 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 6200; Valor: 2500–6200; Unidade: MHz

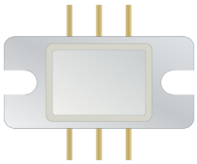
Potência de saída saturada: Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 16; Típico: 16.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 35; Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 28 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS47T

5000–6000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 47 dBm (típico)

5000–6000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 56 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

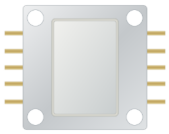
Potência de saída saturada: Mínimo: 46.2; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23.2; Típico: 24; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 50; Típico: 56; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 5%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13400-14600-PS44p5T

13400–14600 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

13400–14600 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 19.5 dB (típico); PAE 32 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13400; Máximo: 14600; Valor: 13400–14600; Unidade: MHz

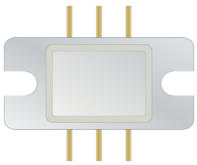
Potência de saída saturada: Mínimo: 43.7; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 19.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 28; Típico: 32; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5000-6000-PS49T

5000–6000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 49 dBm (típico)

5000–6000 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganho de potência 26 dB (típico); PAE 53 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

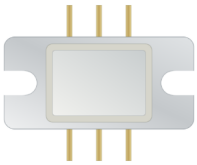
Potência de saída saturada: Mínimo: 48.5; Típico: 49; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 25.5; Típico: 26; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 51; Típico: 53; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 23 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-3700-PS41T

2500–3700 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 41 dBm (típico)

2500–3700 MHz; PSAT 41 dBm (típico); Ganho de potência 22 dB (típico); PAE 47 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 3700; Valor: 2500–3700; Unidade: MHz

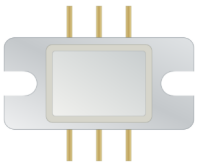
Potência de saída saturada: Mínimo: 40.5; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 21.5; Típico: 22; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 42; Típico: 47; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 19 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-13600-14500-PS41MIN

13600–14500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

13600–14500 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Ganho de potência ≥ 20 dB; PAE 37 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 13600; Máximo: 14500; Valor: 13600–14500; Unidade: MHz

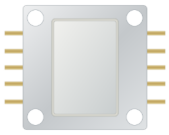
Potência de saída saturada: Mínimo: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 20; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 32; Típico: 37; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; Pin = 21 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-6000-12000-PS46T

6000–12000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 46 dBm (típico)

6000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (típico); Ganho de potência 22 dB (típico); PAE 30 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 12000; Valor: 6000–12000; Unidade: MHz

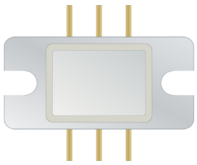
Potência de saída saturada: Típico: 46; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 22; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 30; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 25 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4200-7000-PS41MIN

4200–7000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 41 dBm

4200–7000 MHz; PSAT ≥ 41 dBm; Ganho de potência ≥ 21 dB; PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4200; Máximo: 7000; Valor: 4200–7000; Unidade: MHz

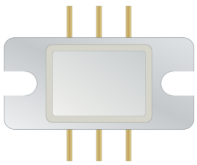
Potência de saída saturada: Mínimo: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 21; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 40; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-5000-PS45MIN

4000–5000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 45 dBm

4000–5000 MHz; PSAT ≥ 45 dBm; Ganho de potência ≥ 26 dB; PAE 50 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 5000; Valor: 4000–5000; Unidade: MHz

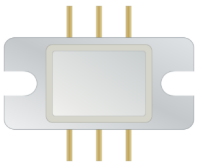
Potência de saída saturada: Mínimo: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 26; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 40; Típico: 50; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-1200-1600-PS42MIN

1200–1600 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 42 dBm

1200–1600 MHz; PSAT ≥ 42 dBm; Ganho de potência ≥ 16 dB; PAE 55 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidade: MHz

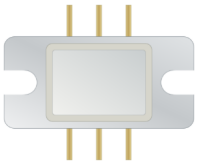
Potência de saída saturada: Mínimo: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 16; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 45; Típico: 55; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -1.8; D = 10%; Pin = 26 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2500-4000-PS46p5T

2500–4000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 46.5 dBm (típico)

2500–4000 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganho de potência 26.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2500; Máximo: 4000; Valor: 2500–4000; Unidade: MHz

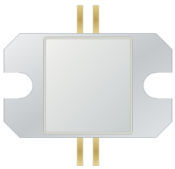
Potência de saída saturada: Mínimo: 46; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 25; Típico: 26.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.3 V; D = 10%; Pin = 20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C

2700–3500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 45.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 45.5 dBm (típico); Ganho de potência 26.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

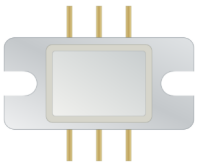
Potência de saída saturada: Mínimo: 44.5; Típico: 45.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 25.5; Típico: 26.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 50; Típico: 55; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS43T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganho de potência 20 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidade: MHz

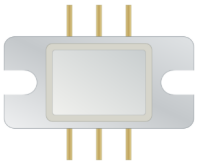
Potência de saída saturada: Mínimo: 42; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 19; Típico: 20; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.2 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 23 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-3400-4800-PS43T

3400–4800 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

3400–4800 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganho de potência 23 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3400; Máximo: 4800; Valor: 3400–4800; Unidade: MHz

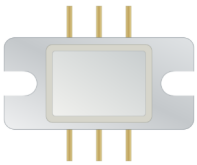
Potência de saída saturada: Mínimo: 42; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 22; Típico: 23; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 35; Típico: 45; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9200-10400-PS45T

9200–10400 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 45 dBm (típico)

9200–10400 MHz; PSAT 45 dBm (típico); Ganho de potência 23 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9200; Máximo: 10400; Valor: 9200–10400; Unidade: MHz

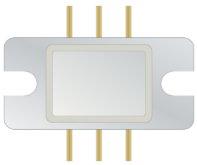
Potência de saída saturada: Mínimo: 44.7; Típico: 45; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 22.7; Típico: 23; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 35; Típico: 38; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 22 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-8000-PS42p5T

2000–8000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 42.5 dBm (típico)

2000–8000 MHz; PSAT 42.5 dBm (típico); Ganho de potência 15.5 dB (típico); PAE 28 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Valor: 2000–8000; Unidade: MHz

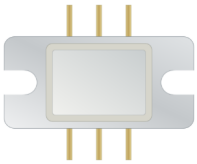
Potência de saída saturada: Mínimo: 40; Típico: 42.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 13; Típico: 15.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 25; Típico: 28; Unidade: %

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.4 V; Pin = 27 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-5800-6800-PS46p5T

5800–6800 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 46.5 dBm (típico)

5800–6800 MHz; PSAT 46.5 dBm (típico); Ganho de potência 21 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5800; Máximo: 6800; Valor: 5800–6800; Unidade: MHz

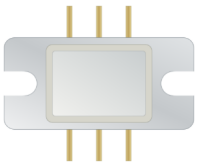
Potência de saída saturada: Mínimo: 45.5; Típico: 46.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 20; Típico: 21; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 26 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS44p5T

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 44.5 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 44.5 dBm (típico); Ganho de potência 17.5 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

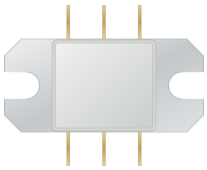
Potência de saída saturada: Mínimo: 44; Típico: 44.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 17; Típico: 17.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 27 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS42T-C

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 42 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 42 dBm (típico); Ganho de potência 21 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

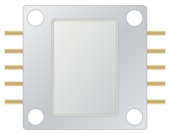
Potência de saída saturada: Típico: 42; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 21; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 38; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 21 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS46T

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 46 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 46 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 37 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

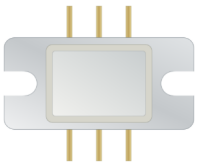
Potência de saída saturada: Típico: 46; Unidade: dBm

Ganho de potência: Típico: 24; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 37; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS36p5T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 36.5 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 36.5 dBm (típico); Ganho de potência 19.5 dB (típico); PAE 35 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidade: MHz

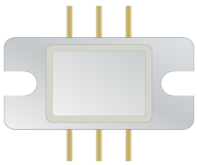
Potência de saída saturada: Mínimo: 36; Típico: 36.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 19; Típico: 19.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 30; Típico: 35; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-4000-8000-PS47T

4000–8000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 47 dBm (típico)

4000–8000 MHz; PSAT 47 dBm (típico); Ganho de potência 19 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 8000; Valor: 4000–8000; Unidade: MHz

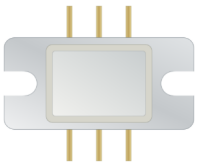
Potência de saída saturada: Mínimo: 46.5; Típico: 47; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 18.5; Típico: 19; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 32; Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 28 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2000-6000-PS43T-C

2000–6000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 43 dBm (típico)

2000–6000 MHz; PSAT 43 dBm (típico); Ganho de potência 26 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

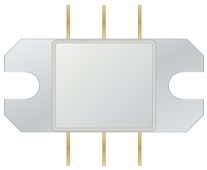
Potência de saída saturada: Mínimo: 42.5; Típico: 43; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 25.5; Típico: 26; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 35; Típico: 45; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 17 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-8000-12000-PS39T-C

8000–12000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 39 dBm (típico)

8000–12000 MHz; PSAT 39 dBm (típico); Ganho de potência 18 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

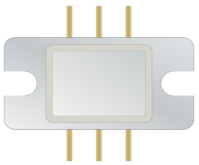
Potência de saída saturada: Mínimo: 37; Típico: 39; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 17; Típico: 18; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 26 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-9000-11000-PS36MIN

9000–11000 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 36 dBm

9000–11000 MHz; PSAT ≥ 36 dBm; Ganho de potência ≥ 23 dB; PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 11000; Valor: 9000–11000; Unidade: MHz

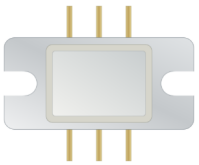
Potência de saída saturada: Mínimo: 36; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 23; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 33; Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.4, -2.4] V; Pin = 13 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-2700-3500-PS31p5T

2700–3500 MHz GaAs Amplificador de potência encapsulado — PSAT 31.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 31.5 dBm (típico); Ganho de potência 36.5 dB (típico); PAE 40 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

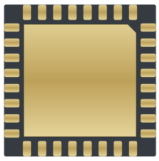
Potência de saída saturada: Mínimo: 31; Típico: 31.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 36; Típico: 36.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 37; Típico: 40; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 8 V; VGS ∈ [-0.8, -0.6] V; Pin = -5 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PA-10-1100-PS40MIN

10–1100 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT ≥ 40 dBm

10–1100 MHz; PSAT ≥ 40 dBm; Ganho de potência ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 10; Máximo: 1100; Valor: 10–1100; Unidade: MHz

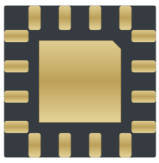
Potência de saída saturada: Mínimo: 40; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 13; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 60; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-4000-12000-NF0p8T

4000–12000 MHz Amplificador de baixo ruído encapsulado — NF 0.8 dB (típico)

4000–12000 MHz; Ganho de pequenos sinais 34 dB (típico); Figura de ruído 0.8 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 7 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 4000; Máximo: 12000; Valor: 4000–12000; Unidade: MHz

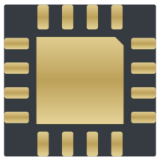
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 34; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 0.8; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 7; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB10p5T

2000–5000 MHz Amplificador de baixo ruído encapsulado — NF 0.65 dB (típico)

2000–5000 MHz; Ganho de pequenos sinais 29 dB (típico); Figura de ruído 0.65 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 10.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz

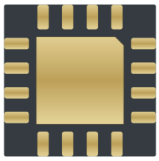
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 29; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 0.65; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 10.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-2000-5000-NF0p65T-P1DB14T

2000–5000 MHz Amplificador de baixo ruído encapsulado — NF 0.65 dB (típico)

2000–5000 MHz; Ganho de pequenos sinais 29 dB (típico); Figura de ruído 0.65 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 14 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 5000; Valor: 2000–5000; Unidade: MHz

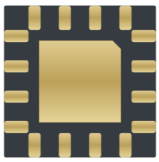
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 29; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 0.65; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 14; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-8000-12000-NF0p9T-SG26T

8000–12000 MHz Amplificador de baixo ruído encapsulado — NF 0.9 dB (típico)

8000–12000 MHz; Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); Figura de ruído 0.9 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB ≥ 7 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

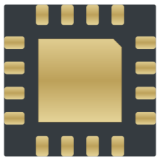
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 0.9; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Mínimo: 7; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -30 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LNA-6000-20000-NF1p5T

6000–20000 MHz Amplificador de baixo ruído encapsulado — NF 1.5 dB (típico)

6000–20000 MHz; Ganho de pequenos sinais 26 dB (típico); Figura de ruído 1.5 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB -2 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 20000; Valor: 6000–20000; Unidade: MHz

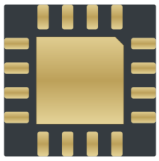
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 26; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 1.5; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: -2; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -40 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2000-7000-P1DB23T

2000–7000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

2000–7000 MHz; Ganho de pequenos sinais 20 dB (típico); Figura de ruído 6 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 23 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 7000; Valor: 2000–7000; Unidade: MHz

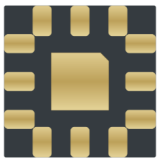
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-100-6000-P1DB20T

100–6000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 20 dBm (típico)

100–6000 MHz; Ganho de pequenos sinais 17 dB (típico); Figura de ruído 1.2 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 20 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 17; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 1.2; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 20; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-100-6000-P1DB22T

100–6000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 22 dBm (típico)

100–6000 MHz; Ganho de pequenos sinais 20 dB (típico); Figura de ruído 2 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 22 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidade: MHz

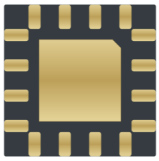
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 2; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 22; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-800-2000-P1DB14p5T

800–2000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 14.5 dBm (típico)

800–2000 MHz; Ganho de pequenos sinais 16.5 dB (típico); Figura de ruído 1.6 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 14.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz

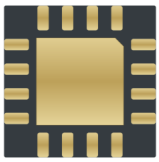
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 16.5; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 1.6; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 14.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-2700-3500-P1DB23T

2700–3500 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

2700–3500 MHz; Ganho de pequenos sinais 27 dB (típico); Figura de ruído 4 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 23 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

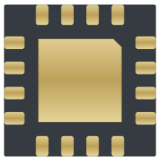
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 27; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 4; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-5000-20000-P1DB19p5T

5000–20000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 19.5 dBm (típico)

5000–20000 MHz; Ganho de pequenos sinais 20 dB (típico); Figura de ruído 6 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 19.5 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 20000; Valor: 5000–20000; Unidade: MHz

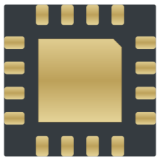
Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB

Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 19.5; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-AMP-14000-18000-P1DB23T-C

14000–18000 MHz Amplificador de ganho RF encapsulado — P1dB 23 dBm (típico)

14000–18000 MHz; Ganho de pequenos sinais 18 dB (típico); Figura de ruído 6 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB 23 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais: Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidade: dB

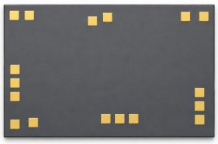
Figura de ruído: Símbolo: NF; Típico: 6; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidade: dBm

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

CIs de front-end de RF



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensões do die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-5000-13000-PS31T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 5000–13000 MHz

PSAT: 31 dBm (típico); Ganho de potência: 18 dB (típico); PAE: 30 % (típico). Dimensões do die: 2.35 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz

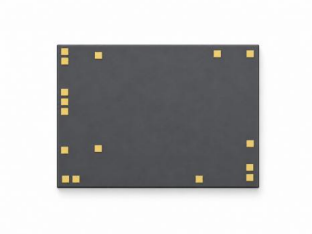
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 31; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 18; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±1.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +16 V; Vg = -2.8 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

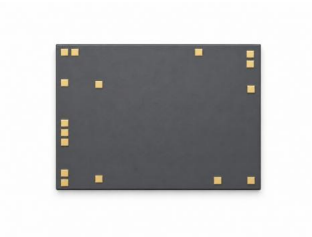
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-8000-12000-PS41T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 8000–12000 MHz

PSAT: 41 dBm (típico); Ganho de potência: 25 dB (típico); PAE: 38 % (típico). Dimensões do die: 3.2 × 2.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

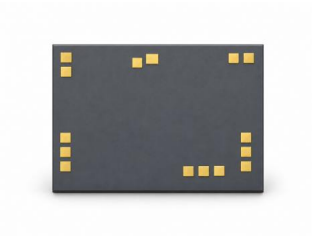
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 41; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 25; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidade: MHz

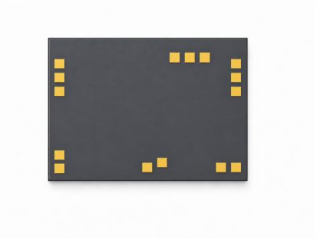
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-9000-10000-PS35T-M

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 9000–10000 MHz

PSAT: 35 dBm (típico); Ganho de potência: 21 dB (típico); PAE: 35 % (típico). Dimensões do die: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 9000; Máximo: 10000; Valor: 9000–10000; Unidade: MHz

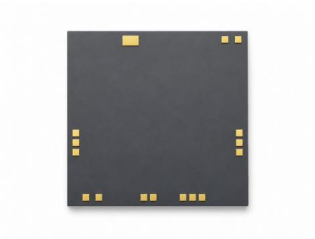
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 35; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Típico: 21; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Máximo: ±0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TRPA-300-6000-PS39T

Die amplificador de potência GaN T/R MMIC de 300–6000 MHz

pulsada: PSAT: 38.7 dBm (mínimo) / 39 dBm (típico) / 40.5 dBm (máximo); Ganho de potência: 10.7 dB (mínimo) / 11 dB (típico) / 12.5 dB (máximo); PAE: 30 % (mínimo) / 35 % (típico) / 53 % (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 3.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 300; Máximo: 6000; Valor: 300–6000; Unidade: MHz

Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Mínimo: 38.7; Típico: 39; Máximo: 40.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Símbolo: Gp; Mínimo: 10.7; Típico: 11; Máximo: 12.5; Unidade: dB

Planicidade do ganho de potência: Símbolo: ΔGp; Típico: ±0.9; Unidade: dB

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; pulsada

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-8000-12000-D-G7p5MIN

8000–12000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase

Passo de fase: 5.625 °; Faixa de atenuação: 0–31.5 dB; Potência de saída na compressão de 1 dB: 11 dBm (mínimo) / 13 dBm (típico). Dimensões do die: 3.8 × 4.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

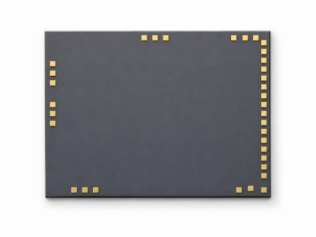
Ganho de pequenos sinais: Mínimo: 7.5; Máximo: 10; Valor: TX / RX; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 35; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Valor: 0–31.5; Unidade: dB

TA = +25 °C; f(Typ) = 10000 MHz; f(Min/Max) = 8000–12000 MHz

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-7000-13000

7000–13000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase

Passo de fase: 5.625 ° (típico); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo); Ganho de pequenos sinais: 12 dB (típico) (RX). Dimensões do die: 4.55 × 3.54 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

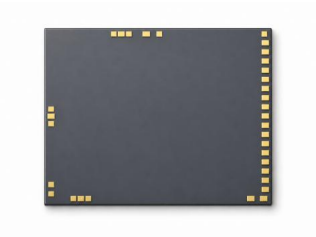
Ganho de pequenos sinais: Típico: 12; Valor: RX; Unidade: dB

Potência de saída na compressão de 1 dB: Típico: 11; Valor: RX; Unidade: dBm

Potência de saída saturada: Típico: 24; Valor: TX; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-5000-6000

5000–6000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase — Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico)

5000–6000 MHz; Rx 13 dB / Tx 27 dB (típico); Rx P1dB ≥ 10 dBm; Tx PSAT ≥ 23 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

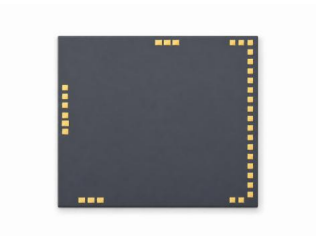
Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 13; Unidade: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-APC-8000-12000-D-RXG10T

8000–12000 MHz Die front-end RF GaAs MMIC com controle de amplitude e fase — Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico)

8000–12000 MHz; Rx 10 dB / Tx 26 dB (típico); Rx P1dB ≥ 13.5 dBm; Tx PSAT ≥ 25 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

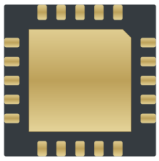
Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Ganho de pequenos sinais (Rx): Típico: 10; Unidade: dB

TA = +25 °C; VS = -5 V; Vd1 = Vd2 = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-8000-18000-RXP1DB23T

8000–18000 MHz CI front-end RF bidirecional — RX / TX P1dB 23 dBm (típico)

8000–18000 MHz; Ganho de pequenos sinais (Rx) 20 dB (típico); Ganho de pequenos sinais (Tx) 20 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx) 23 dBm (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB (Tx) 23 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 18000; Valor: 8000–18000; Unidade: MHz

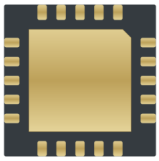
Ganho de pequenos sinais (Rx): Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB; Notas: RX

Ganho de pequenos sinais (Tx): Símbolo: Gain; Típico: 20; Unidade: dB; Notas: TX

Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Símbolo: P_1; Típico: 23; Unidade: dBm; Notas: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BDA-6000-18000-RXP1DB20T

6000–18000 MHz CI front-end RF bidirecional — RX / TX P1dB 20 dBm (típico)

6000–18000 MHz; Ganho de pequenos sinais (Rx) 18 dB (típico); Ganho de pequenos sinais (Tx) 18 dB (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx) 20 dBm (típico); Potência de saída na compressão de 1 dB (Tx) 20 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

Ganho de pequenos sinais (Rx): Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidade: dB; Notas: RX

Ganho de pequenos sinais (Tx): Símbolo: Gain; Típico: 18; Unidade: dB; Notas: TX

Potência de saída na compressão de 1 dB (Rx): Símbolo: P_1; Típico: 20; Unidade: dBm; Notas: RX

TA = +25 °C; VD = +5 V; Pin = -20 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Dispositivos RF bare die e chip-scale



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nível de limitação: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 1 ms; D = 20%). Dimensões do die: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz

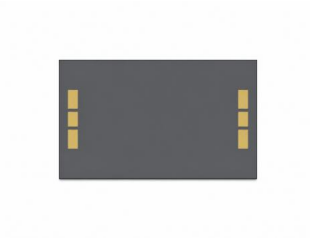
Perda de inserção: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.45 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nível de limitação: 18.5 dBm (típico) / 19.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 49 dBm (máximo) (τ = 2 ms; D = 20%); Potência máxima de entrada pulsada: 50 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.45; Máximo: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.5 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

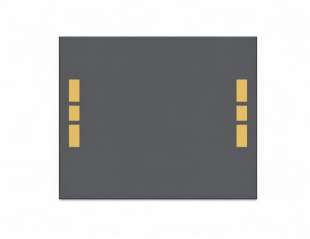
Perda de inserção: Típico: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 43 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 20%). Dimensões do die: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

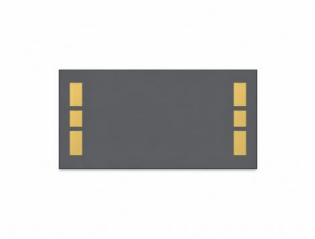
Perda de inserção: Típico: 0.3; Máximo: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 16.5 dBm (típico) / 17.5 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 42 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

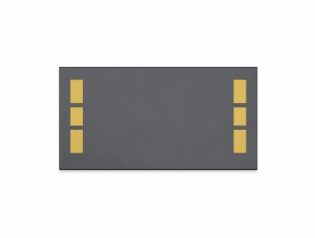
Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de saída: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 41 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.6; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 48 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%); Potência de entrada máxima: 46 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.4 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência de entrada máxima: 37 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 14000; Valor: DC–14000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.4; Máximo: 0.5; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.6 dB (típico) / 0.7 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.6; Máximo: 0.7; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6

VSWR de saída: Típico: 1.6

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.3 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 37 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.3; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2; Máximo: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 17 dBm (típico) / 18 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 200 µs; D = 30%). Dimensões do die: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 10000; Máximo: 18000; Valor: 10000–18000; Unidade: MHz

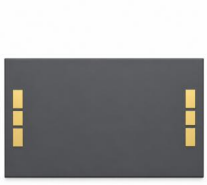
Perda de inserção: Típico: 0.8; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

VSWR de saída: Típico: 1.6; Máximo: 1.8

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.35 dB (típico) / 0.4 dB (máximo); Nível de limitação: 15 dBm (típico) / 16 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 45 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%). Dimensões do die: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 6000; Valor: DC–6000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.35; Máximo: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

VSWR de saída: Típico: 1.4; Máximo: 1.5

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Perda de inserção: 0.4 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 51 dBm (máximo) (τ = 100 µs; D = 10%); Potência de entrada máxima: 48 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 4000; Valor: 2000–4000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.4; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R15OHM

15 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 15 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.35 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.8 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1

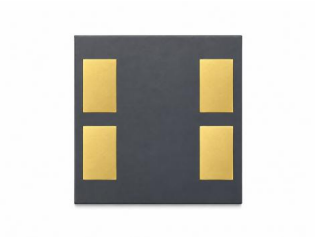
Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 15; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 20 / 20 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.165 / 0.165 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.33 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 2

Número de terminais: Valor: 4

Resistência: Típico: 20 / 20; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R50OHM

50 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 50 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.2 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.6 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1

Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 50; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCRES-R1000OHM

1000 Ω Die resistor de filme fino GaAs

Resistência: 1000 Ω (típico); Corrente de operação linear: 0.04 A (típico); Corrente máxima admissível: 0.08 A (máximo). Dimensões do die em planta: 0.5 × 0.5 mm.

Número de resistores: Valor: 1

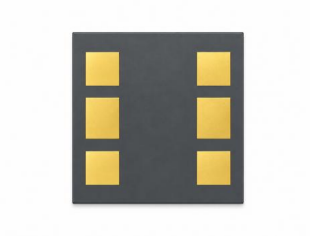
Número de terminais: Valor: 2

Resistência: Típico: 1000; Unidade: Ω

Tolerância da resistência: Típico: ±5; Unidade: %

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCCAP-C10PF

10 pF Die capacitor GaAs

Capacitância: 10 pF (típico); Tensão suportável: 50 V (típico). Dimensões do die: 0.5 × 0.5 × 0.1 mm.

Capacitância: Típico: 10; Unidade: pF; TA = +25 °C

Tensão suportável: Típico: 50; Unidade: V; TA = +25 °C

Tensão de ruptura: Valor: 80 (Vb); Unidade: V

Temperatura de armazenamento: Mínimo: -65; Máximo: 150; Unidade: °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCEQ-8000-12000-D

8000–12000 MHz Die equalizador de inclinação GaAs

Amplitude de equalização: 2 dB; Perda de inserção @ 8000 MHz: 2.6 dB; Perda de inserção @ 12000 MHz: 0.7 dB. Dimensões do die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

Amplitude de equalização: Valor: 2; Unidade: dB

Perda de inserção @ 8000 MHz: Valor: 2.6; Unidade: dB

Perda de inserção @ 12000 MHz: Valor: 0.7; Unidade: dB

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCEQ-2000-6000-D

2000–6000 MHz Die equalizador de inclinação GaAs

Amplitude de equalização: 5.5 dB; Perda de inserção @ 2000 MHz: 0.6 dB; Perda de inserção @ 6000 MHz: 6.1 dB. Dimensões do die: 0.8 × 0.9 × 0.1 mm.

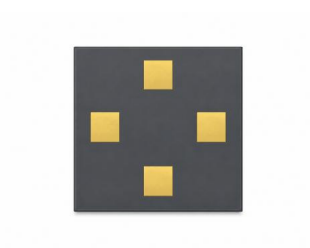
Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

Amplitude de equalização: Valor: 5.5; Unidade: dB

Perda de inserção @ 2000 MHz: Valor: 0.6; Unidade: dB

Perda de inserção @ 6000 MHz: Valor: 6.1; Unidade: dB

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCXOV-DC-40000-D

DC–40000 MHz Die de cruzamento RF GaAs

Perda de inserção: 0.4 dB (típico); Isolamento: 30 dB (típico); Perda de retorno: 20 dB (típico). Dimensões do die: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 0.4; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

Perda de retorno: Típico: 20; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCBPF-17000-19000

17000–19000 MHz GaAs Die filtro passa-faixa — IL 2.7 dB (típico)

17000–19000 MHz; Perda de inserção 2.7 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 17000; Máximo: 19000; Valor: 17000–19000; Unidade: MHz

Frequência central: Típico: 18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 2.7; Unidade: dB

Ondulação na faixa de passagem: Típico: 0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Circuitos integrados de comutação de RF



LCI-SW-1000-12000-SPDT

1000–12000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC

Perda de inserção: 1 dB (típico); Isolamento: 34 dB (mínimo) / 63 dB (máximo); Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: 43 dBm (típico). Dimensões do die: 2.45 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1000; Máximo: 12000; Valor: 1000–12000; Unidade: MHz

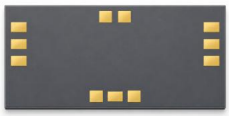
Perda de inserção: Típico: 1; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 34; Máximo: 63; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 43; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-12000-18000-SPDT

12000–18000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

12000–18000 MHz; Perda de inserção 1 dB (típico); Isolamento 38 dB (típico); P0.2dB 44 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 1; Máximo: 1.2; Unidade: dB

Isolamento: Mínimo: 36; Típico: 38; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 44; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-32000-38000-SPDT

32000–38000 MHz Die chave SPDT MMIC — IL 1 dB (típico)

32000–38000 MHz; Perda de inserção 1 dB (típico); Isolamento 20 dB (típico); P0.2dB 42 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 32000; Máximo: 38000; Valor: 32000–38000; Unidade: MHz

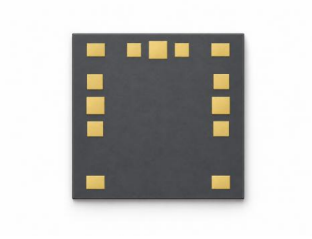
Perda de inserção: Típico: 1; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 42; Unidade: dBm

Von = -28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-2000-18000-SPDT

2000–18000 MHz Die chave SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

2000–18000 MHz; Perda de inserção 0.9 dB (típico); Isolamento 23 dB (típico); P0.2dB 37 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz

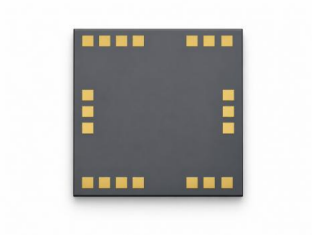
Perda de inserção: Típico: 0.9; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 23; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 37; Unidade: dBm

Von = +28 V; Voff = 0 V; TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP3T-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SP3T MMIC — IL ≤ 2.8 dB (2000–20000 MHz)

100–20000 MHz; Perda de inserção (100–2000 MHz) ≤ 1.4 dB; Isolamento (100–2000 MHz) ≤ 65 dB.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

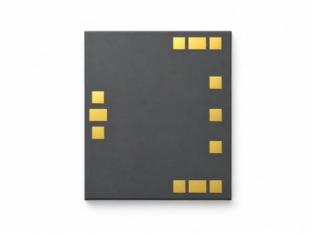
Perda de inserção (100–2000 MHz): Máximo: 1.4; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidade: dB

Perda de inserção (2000–20000 MHz): Máximo: 2.8; Valor: f = 2000–20000 MHz; Unidade: dB

Isolamento (100–2000 MHz): Máximo: 65; Valor: f = 100–2000 MHz; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPDT-D-IL1p6T

100–20000 MHz GaAs Die chave SPDT MMIC — IL 1.6 dB (típico)

100–20000 MHz; Perda de inserção 1.6 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz; TA = +25 °C

Perda de inserção: Típico: 1.6; Unidade: dB; TA = +25 °C

Isolamento: Típico: 45; Unidade: dB; TA = +25 °C

Corrente de repouso da alimentação negativa: Típico: 0.0012; Unidade: A

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-8000-12000-SPDT

8000–12000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.9 dB (típico)

8000–12000 MHz; Perda de inserção 0.9 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico); P0.2dB 46 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

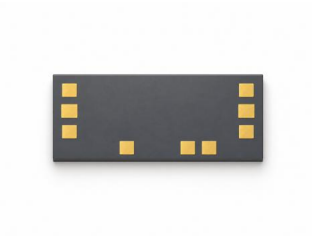
Perda de inserção: Típico: 0.9; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 45; Máximo: 50; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 46; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPST-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SPST MMIC — IL ≤ 1.2 dB

100–20000 MHz; Perda de inserção ≤ 1.2 dB; Isolamento 60 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Máximo: 1.2; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 60; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída (ligado): Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-2700-3500-SPDT

2700–3500 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

2700–3500 MHz; Perda de inserção 0.7 dB (típico); Isolamento 41 dB (típico); P0.2dB 51 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

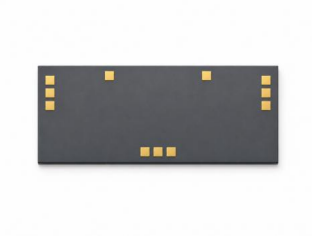
Perda de inserção: Típico: 0.7; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 41; Máximo: 43; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 51; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-6000-SPDT

100–6000 MHz GaN Die chave SPDT MMIC — IL 0.7 dB (típico)

100–6000 MHz; Perda de inserção 0.7 dB (típico); Isolamento 45 dB (típico); P0.2dB 47 dBm (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 6000; Valor: 100–6000; Unidade: MHz

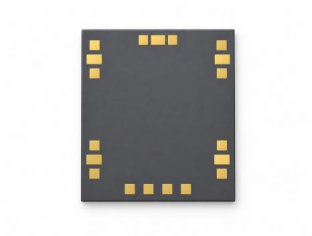
Perda de inserção: Típico: 0.7; Máximo: 0.8; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 45; Unidade: dB

Potência de entrada na compressão de 0.2 dB: Típico: 47; Unidade: dBm

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP4T-D

100–20000 MHz GaAs Die chave SP4T MMIC — IL −2 dB (típico)

100–20000 MHz; Perda de inserção -2 dB (típico); Isolamento -50 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

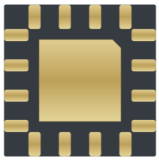
Perda de inserção: Típico: -2; Unidade: dB

Isolamento: Típico: -50; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPST-C

100–20000 MHz CI chave RF — SPST; TTL

100–20000 MHz; SPST; Perda de inserção -1.8 dB (típico); Isolamento 60 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

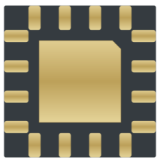
Perda de inserção: Símbolo: IL; Típico: -1.8; Unidade: dB

Isolamento: Símbolo: ISO; Típico: 60; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída (ligado): Típico: 1.14

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP3T-C

100–20000 MHz CI chave RF — SP3T; TTL

100–20000 MHz; SP3T; Perda de inserção -3.1 dB (típico); Isolamento 50 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

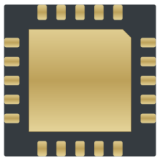
Perda de inserção: Símbolo: IL; Típico: -3.1; Unidade: dB

Isolamento: Símbolo: ISO; Típico: 50; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída (ligado): Típico: 1.14

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SP4T-C

100–20000 MHz CI chave RF — SP4T; TTL

100–20000 MHz; SP4T; Perda de inserção -2.6 dB (típico); Isolamento -50 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

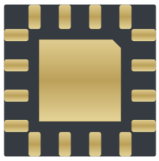
Perda de inserção: Símbolo: IL; Típico: -2.6; Unidade: dB

Isolamento: Símbolo: ISO; Típico: -50; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-SW-100-20000-SPDT-C

100–20000 MHz CI chave RF — SPDT; TTL

100–20000 MHz; SPDT; Perda de inserção -2.2 dB (típico); Isolamento -45 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 20000; Valor: 100–20000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Símbolo: IL; Típico: -2.2; Unidade: dB

Isolamento: Símbolo: ISO; Típico: -45; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.22

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Circuitos integrados beamformer RF



LCI-BF-14000-18000-4CH

14000–18000 MHz Die formador de feixes SiGe T/R de quatro canais

Passo de fase: 5.625 °; Faixa de atenuação: 0–31.5 dB; Tempo de comutação: 100 ns (máximo). Dimensões do die em planta: 5 × 6.2 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

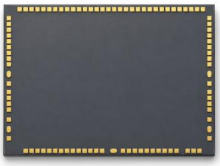
VSWR de entrada/saída: Típico: 1.8

Erro RMS de fase: Máximo: 3; Unidade: °

Erro RMS de atenuação: Máximo: 0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BF-8000-12000-2CH

8000–12000 MHz Die formador de feixes Si T/R de dois canais

Passo de fase: 5.625 ° (típico); Passo de atenuação: 0.5 dB (típico). Dimensões do die: 3.6 × 2.7 × 0.15 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

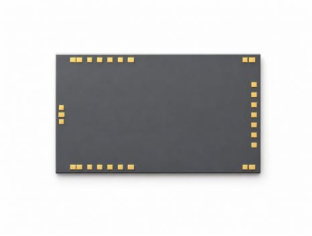
Resolução de controle de fase: Valor: 6; Unidade: bit

Resolução de controle de atenuação: Valor: 6; Unidade: bit

Faixa de defasagem: Mínimo: 0; Máximo: 360; Unidade: °

CLK = 50 MHz; RFVDD = AVDD = DVDD = 3.3 V; TA = +27 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-BF-3700-5000-2CH

3700–5000 MHz Die GaAs MMIC de controle de fase e atenuação de dois canais — 2 × 6-bit ϕ / 6-bit ATT

3700–5000 MHz; Perda de inserção -13 dB (típico); Erro RMS de atenuação em 64 estados 0.2 dB (típico); Erro RMS de fase em 64 estados 2 ° (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: -13; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação em 64 estados: Típico: 0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C; VEE = -5 V; Vd = +5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Circuitos integrados defasadores RF



LCI-PS-1200-1400-6B-D

1200–1400 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 0.5 ° (mínimo) / 0.7 ° (típico) / 1 ° (máximo); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo); Perda de inserção: ≈5 dB. Dimensões do die: 4 × 1.7 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1200; Máximo: 1400; Valor: 1200–1400; Unidade: MHz

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Mínimo: 0.5; Típico: 0.7; Máximo: 1; Unidade: °

Variação de amplitude induzida pela defasagem: Típico: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-5000-6000-6B

5000–6000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1 ° (típico); Perda de inserção: 7 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

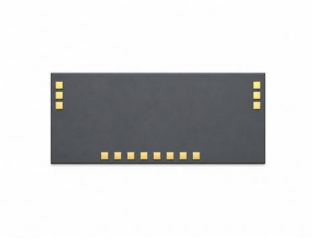
Perda de inserção: Típico: 7; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1; Unidade: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-2700-3500-6B

2700–3500 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1 ° (típico); Perda de inserção: 5.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.3 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 5.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1; Unidade: °

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-15000-23000-6B

15000–23000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.4 ° (típico); Perda de inserção: 9.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 15000; Máximo: 23000; Valor: 15000–23000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 9.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.4; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-25000-33000-6B

25000–33000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.6 ° (típico); Perda de inserção: 9.5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.1 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 25000; Máximo: 33000; Valor: 25000–33000; Unidade: MHz

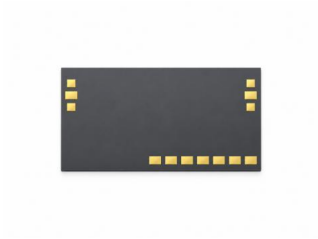
Perda de inserção: Típico: 9.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.6; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.2 ° (típico); Perda de inserção: 7 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 2.5 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

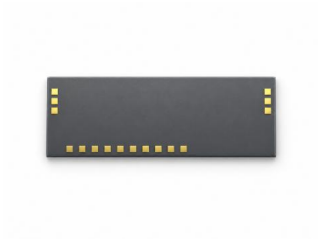
Perda de inserção: Típico: 7; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.2; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-900-1400-6B-D

900–1400 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 1.5 ° (típico); Perda de inserção: 5 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.6 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 900; Máximo: 1400; Valor: 900–1400; Unidade: MHz

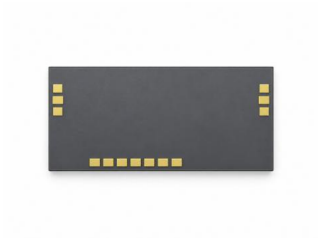
Perda de inserção: Típico: 5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 1.5; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-1200-1600-6B-D

1200–1600 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 0.8 ° (típico); Perda de inserção: 4.3 dB (típico); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 3.3 × 1.6 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 4.3; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 0.8; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-2000-8000-6B

2000–8000 MHz Die defasador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de fase: 2.2 ° (típico) / 3 ° (máximo); Perda de inserção: 10 dB (típico) / 11.5 dB (máximo); Faixa de defasagem: 5.625 ° (mínimo) / 354.375 ° (máximo). Dimensões do die: 5 × 1.75 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 8000; Valor: 2000–8000; Unidade: MHz

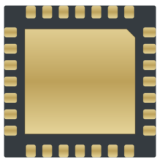
Perda de inserção: Típico: 10; Máximo: 11.5; Unidade: dB

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Erro RMS de fase: Típico: 2.2; Máximo: 3; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-900-1400-6B-C

900–1400 MHz CI defasador digital — 6-bit; RMS 1.5° (típico)

900–1400 MHz; Erro RMS de fase em 64 estados 1.5 ° (típico); Variação de amplitude induzida pela defasagem ±0.4 dB (típico); VSWR de entrada 1.5 (típico); VSWR de saída 1.4 (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 900; Máximo: 1400; Valor: 900–1400; Unidade: MHz

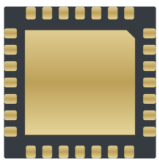
Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Perda de inserção: Típico: -5.4; Unidade: dB

Erro RMS de fase em 64 estados: Típico: 1.5; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-1200-1400-6B-C

1200–1400 MHz CI defasador digital — 6-bit; RMS 0.7° (típico)

1200–1400 MHz; Erro RMS de fase em 64 estados 0.7 ° (típico); Variação de amplitude induzida pela defasagem ±0.5 dB (típico); VSWR de entrada 1.4 (típico); VSWR de saída 1.4 (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1400; Valor: 1200–1400; Unidade: MHz

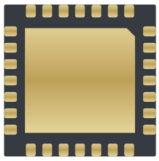
Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Perda de inserção: Típico: -5.4; Unidade: dB

Erro RMS de fase em 64 estados: Típico: 0.7; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-1200-1600-6B-C

1200–1600 MHz CI defasador digital — 6-bit; RMS 0.8° (típico)

1200–1600 MHz; Erro RMS de fase em 64 estados 0.8 ° (típico); Variação de amplitude induzida pela defasagem ±0.4 dB (típico); VSWR de entrada 1.4 (típico); VSWR de saída 1.4 (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 1200; Máximo: 1600; Valor: 1200–1600; Unidade: MHz

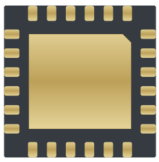
Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Máximo: 354.375; Unidade: °

Perda de inserção: Típico: -4.7; Unidade: dB

Erro RMS de fase em 64 estados: Típico: 0.8; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-PS-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz CI defasador digital — 6-bit; RMS 1.2° (típico)

14000–18000 MHz; Erro RMS de fase em 64 estados 1.2 ° (típico); Variação de amplitude induzida pela defasagem ±0.3 dB (típico); VSWR de entrada 1.5 (típico); VSWR de saída 1.3 (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Faixa de defasagem: Mínimo: 5.625; Unidade: °

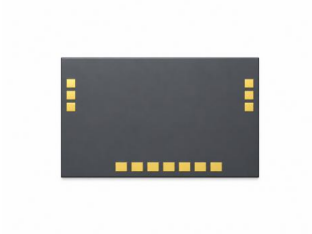
Perda de inserção: Típico: -7.4; Unidade: dB

Erro RMS de fase em 64 estados: Típico: 1.2; Unidade: °

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Circuitos integrados atenuadores digitais de RF



LCI-ATT-14000-18000-6B-D

14000–18000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de atenuação: 0.3 dB (típico); Perda de inserção: 4 dB (máximo); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensões do die: 2.5 × 1.5 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

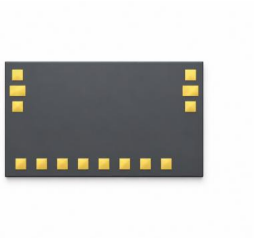
Perda de inserção: Máximo: 4; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação: Típico: 0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-ATT-DC-8000-6B

DC–8000 MHz Die atenuador digital GaAs MMIC de 6 bits

Erro RMS de atenuação: 0.2 dB (típico); Perda de inserção: 1.6 dB (típico); Faixa de atenuação: 0.5 dB (mínimo) / 31.5 dB (máximo). Dimensões do die: 1.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 8000; Valor: DC–8000; Unidade: MHz

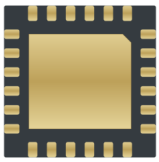
Perda de inserção: Típico: 1.6; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Erro RMS de atenuação: Típico: 0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-ATT-100-8000-6B

100–8000 MHz CI atenuador digital por passos — 6-bit; 0.5 dB

100–8000 MHz; Faixa de atenuação 0.5–31.5 dB; Precisão de atenuação 0.2 dB (típico); Perda de inserção 2 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 100; Máximo: 8000; Valor: 100–8000; Unidade: MHz

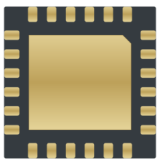
Perda de inserção: Típico: 2; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Precisão de atenuação: Típico: 0.2; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-ATT-14000-18000-6B-C

14000–18000 MHz CI atenuador digital por passos — 6-bit; 0.5 dB

14000–18000 MHz; Faixa de atenuação 0.5–31.5 dB; Precisão de atenuação 0.3 dB (típico); Perda de inserção 2 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 14000; Máximo: 18000; Valor: 14000–18000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 2; Unidade: dB

Faixa de atenuação: Mínimo: 0.5; Máximo: 31.5; Unidade: dB

Precisão de atenuação: Típico: 0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-5000-6000-4B

5000–6000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Atraso temporal: 92.5 ps (típico) (T1; t_nom = 92.59 ps); Atraso temporal: 737 ps (típico) (T4; t_nom = 740.74 ps); Perda de inserção: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensões do die: 4.5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 6000; Valor: 5000–6000; Unidade: MHz

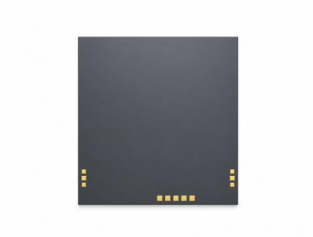
Perda de inserção: Típico: 12; Máximo: 13; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 92.5; Valor: T1; t_nom = 92.59 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 184; Valor: T2; t_nom = 185.185 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-8500-10500-4B

8500–10500 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 4 bits

Atraso temporal: 52.7 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Atraso temporal: 416 ps (típico) (T4; t_nom = 416 ps); Perda de inserção: 12 dB (típico) / 13 dB (máximo). Dimensões do die: 4 × 4.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8500; Máximo: 10500; Valor: 8500–10500; Unidade: MHz

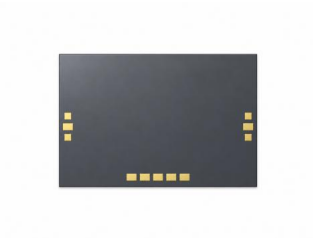
Perda de inserção: Típico: 12; Máximo: 13; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 52.7; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 102; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-8000-12000-3B

8000–12000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Atraso temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Atraso temporal: 102 ps (típico) (T3; t_nom = 100 ps); Perda de inserção: 6 dB (típico) / 7 dB (máximo). Dimensões do die: 3 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

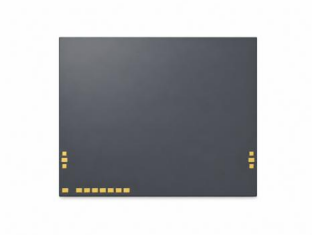
Perda de inserção: Típico: 6; Máximo: 7; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 25; Valor: T1; t_nom = 25 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 49.5; Valor: T2; t_nom = 50 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-200-2000-6B

200–2000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 6 bits

Atraso temporal: 25 ps (típico) (T1; t_nom = 25 ps); Atraso temporal: 800 ps (típico) (T6; t_nom = 800 ps); Perda de inserção: 11 dB (máximo). Dimensões do die: 5 × 4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 200; Máximo: 2000; Valor: 200–2000; Unidade: MHz

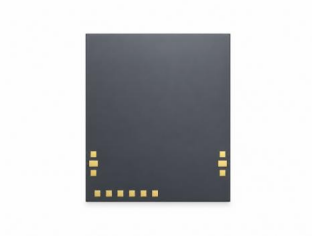
Perda de inserção: Máximo: 11; Unidade: dB

Atraso temporal (T1): Típico: 25; Unidade: ps; Notas: T1; t_nom = 25 ps

Atraso temporal (T2): Típico: 50; Unidade: ps; Notas: T2; t_nom = 50 ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-TTD-7000-13000-3B

7000–13000 MHz Die de atraso temporal digital GaAs MMIC de 3 bits

Atraso temporal: 52 ps (típico) (T1; t_nom = 52 ps); Atraso temporal: 208 ps (típico) (T3; t_nom = 208 ps); Perda de inserção: 9 dB (típico). Dimensões do die: 2.5 × 2.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: 9; Unidade: dB

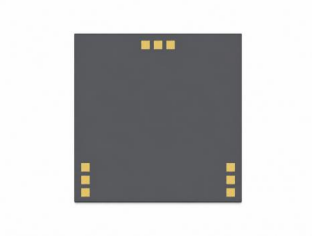
Atraso temporal (T1): Típico: 52; Valor: T1; t_nom = 52 ps; Unidade: ps

Atraso temporal (T2): Típico: 104; Valor: T2; t_nom = 104 ps; Unidade: ps

TA = +25 °C; VEE = -5 V

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Dispositivos passivos RF integrados



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 2 × 2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 3700; Máximo: 5000; Valor: 3700–5000; Unidade: MHz

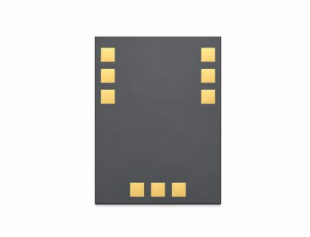
Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 14 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 500; Máximo: 2700; Valor: 500–2700; Unidade: MHz

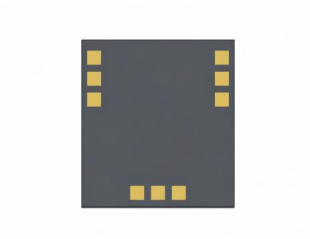
Isolamento: Típico: 14; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 1.1 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 800; Máximo: 2000; Valor: 800–2000; Unidade: MHz

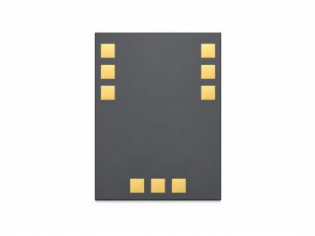
Isolamento: Típico: 18; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 18 dB (típico); VSWR de entrada: 1.4 (típico); VSWR de saída: 1.4 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 1000; Máximo: 4000; Valor: 1000–4000; Unidade: MHz

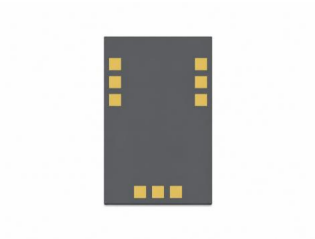
Isolamento: Típico: 18; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.4

VSWR de saída: Típico: 1.4

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

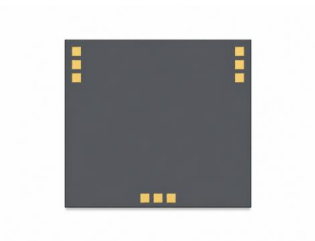
Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2000; Máximo: 18000; Valor: 2000–18000; Unidade: MHz

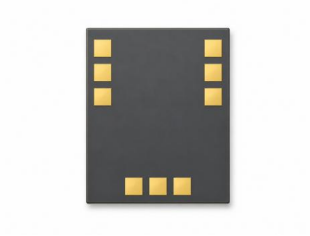
Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

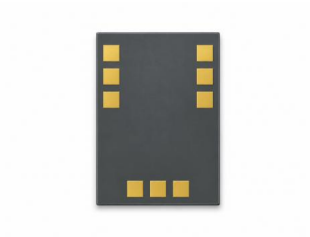
Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.1 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 7000; Valor: 5000–7000; Unidade: MHz

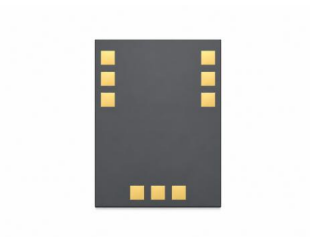
Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.1

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.2 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 5000; Máximo: 13000; Valor: 5000–13000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 6000; Máximo: 18000; Valor: 6000–18000; Unidade: MHz

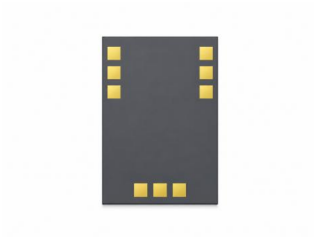
Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 13000; Valor: 7000–13000; Unidade: MHz

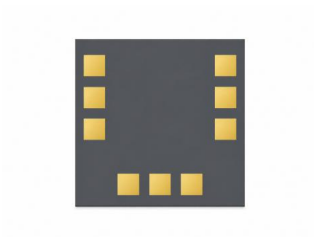
Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 0.8 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 8000; Máximo: 12000; Valor: 8000–12000; Unidade: MHz

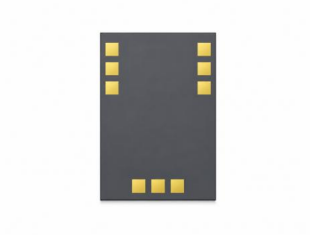
Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 10000; Máximo: 20000; Valor: 10000–20000; Unidade: MHz

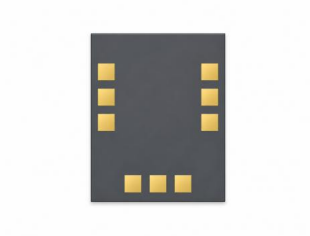
Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.1 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 12000; Máximo: 18000; Valor: 12000–18000; Unidade: MHz

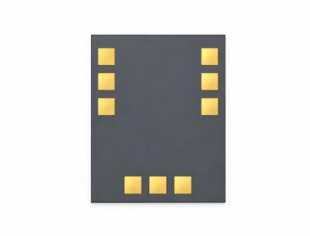
Isolamento: Típico: 25; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.2

VSWR de saída: Típico: 1.1

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 20 dB (típico); VSWR de entrada: 1.3 (típico); VSWR de saída: 1.3 (típico). Dimensões do die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 30000; Máximo: 40000; Valor: 30000–40000; Unidade: MHz

Isolamento: Típico: 20; Unidade: dB

VSWR de entrada: Típico: 1.3

VSWR de saída: Típico: 1.3

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 0 dB

Atenuação: 0 dB; VSWR de entrada/saída: 1.2 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 0; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.2

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 1 dB

Atenuação: 1 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 1; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 2 dB

Atenuação: 2 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 2; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 3 dB

Atenuação: 3 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 3; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 4 dB

Atenuação: 4 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 4; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 8 dB

Atenuação: 8 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 8; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 16 dB

Atenuação: 16 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 16; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 0 dB

Atenuação: 0 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.6 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 0; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.6; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 1 dB

Atenuação: 1 dB; VSWR de entrada/saída: 1.4 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 1; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.4

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 2 dB

Atenuação: 2 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 2; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 3 dB

Atenuação: 3 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 3; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 5 dB

Atenuação: 5 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 5; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 6 dB

Atenuação: 6 dB; VSWR de entrada/saída: 1.35 ; Planicidade da atenuação: ±0.4 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 6; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.35

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.4; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 8 dB

Atenuação: 8 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.3 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

Atenuação: Valor: 8; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.3; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Die atenuador fixo GaAs IPD de 10 dB

Atenuação: 10 dB; VSWR de entrada/saída: 1.3 ; Planicidade da atenuação: ±0.5 dB. Dimensões do die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidade: MHz

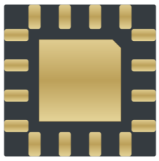
Atenuação: Valor: 10; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Valor: 1.3

Planicidade da atenuação: Valor: ±0.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz Cruzamento RF encapsulado — ISO 30 dB (típico)

DC–40000 MHz; Perda de inserção -1.4 dB (típico); Isolamento 30 dB (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: DC; Máximo: 40000; Valor: DC–40000; Unidade: MHz

Perda de inserção: Típico: -1.4; Unidade: dB

Isolamento: Típico: 30; Unidade: dB

VSWR de entrada/saída: Típico: 1.2

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Circuitos integrados misturadores e conversores



LCI-MIX-500-2000-D

500–2000 MHz Die misturador passivo duplamente balanceado GaAs MMIC

Perda de conversão: 9 dB (típico); Potência de LO: 15 dBm; Frequência de operação (IF): 0 MHz (mínimo) / 900 MHz (máximo) / DC–900 MHz. Dimensões do die: 2.1 × 1.45 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 500; Máximo: 2000; Valor: 500–2000 (RF / LO); Unidade: MHz

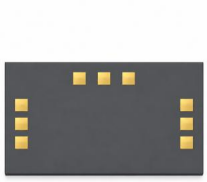
Frequência de operação (IF): Mínimo: 0; Máximo: 900; Valor: DC–900; Unidade: MHz

Perda de conversão: Típico: 9; Unidade: dB

Isolamento (LO / RF): Típico: 45; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-MIX-7000-10000-D

7000–10000 MHz Die misturador passivo duplamente balanceado GaAs MMIC

Perda de conversão: 8.5 dB (típico); Potência de LO: 14 dBm; Frequência de operação (IF): 1400 MHz (mínimo) / 3000 MHz (máximo) / 1400–3000 MHz. Dimensões do die: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Frequência de operação: Mínimo: 7000; Máximo: 10000; Valor: 7000–10000 (RF); Unidade: MHz

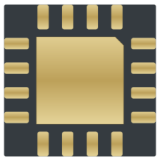
Frequência de operação (LO): Mínimo: 5000; Máximo: 9000; Valor: 5000–9000; Unidade: MHz

Frequência de operação (IF): Mínimo: 1400; Máximo: 3000; Valor: 1400–3000; Unidade: MHz

Perda de conversão: Típico: 8.5; Unidade: dB

TA = +25 °C

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-MIX-500-2000-C

500–2000 MHz Misturador passivo duplamente balanceado encapsulado — LO +14 dBm; IL -9 dB (típico)

500–2000 MHz; IF DC–900 MHz; Perda de conversão -9 dB (típico); LOin = 14 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 500; Máximo: 2000; Valor: 500–2000; Unidade: MHz

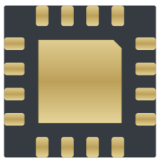
Faixa de frequência IF: Mínimo: DC; Máximo: 900; Unidade: MHz

Perda de conversão: Símbolo: IL; Típico: -9; Unidade: dB

Isolação LO–RF: Símbolo: ISOL-R; Típico: -40; Unidade: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCI-MIX-7000-10000-C

7000–10000 MHz Misturador passivo duplamente balanceado encapsulado — LO +14 dBm; IL -9 dB (típico)

7000–10000 MHz; IF 1400–3400 MHz; Perda de conversão -9 dB (típico); LOin = 14 dBm.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 7000; Máximo: 10000; Valor: 7000–10000; Unidade: MHz

Faixa de frequência IF: Mínimo: 1400; Máximo: 3400; Unidade: MHz

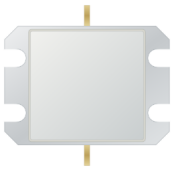
Perda de conversão: Símbolo: IL; Típico: -9; Unidade: dB

Isolação LO–RF: Símbolo: ISOL-R; Típico: -40; Unidade: dB

TA = +25 °C; LOin = 14 dBm; RFin = -10 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Transistores de potência RF



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 51 dBm (típico)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganho de potência 11 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5700; Máximo: 7100; Valor: 5700–7100; Unidade: MHz

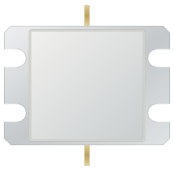
Potência de saída saturada: Mínimo: 50.5; Típico: 51; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 10.5; Típico: 11; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 56.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganho de potência 13.5 dB (típico); PAE 55 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

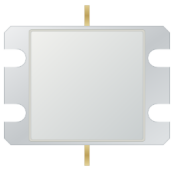
Potência de saída saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 50; Típico: 55; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 56.5 dBm (típico)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (típico); Ganho de potência 12.5 dB (típico); PAE 45 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 5300; Máximo: 5900; Valor: 5300–5900; Unidade: MHz

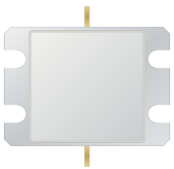
Potência de saída saturada: Mínimo: 56; Típico: 56.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 40; Típico: 45; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 48.5 dBm (típico)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (típico); Ganho de potência 12.5 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3900; Valor: 2700–3900; Unidade: MHz

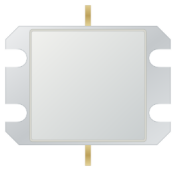
Potência de saída saturada: Mínimo: 48; Típico: 48.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 12; Típico: 12.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 53.5 dBm (típico)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (típico); Ganho de potência 13.5 dB (típico); PAE 65 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2700; Máximo: 3500; Valor: 2700–3500; Unidade: MHz

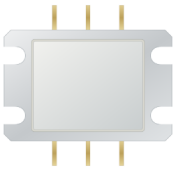
Potência de saída saturada: Mínimo: 53; Típico: 53.5; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 13; Típico: 13.5; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 60; Típico: 65; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 50 dBm (típico)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (típico); Ganho de potência 12 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2300; Máximo: 3900; Valor: 2300–3900; Unidade: MHz

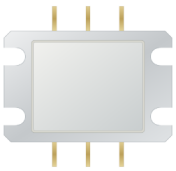
Potência de saída saturada: Mínimo: 49; Típico: 50; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 11; Típico: 12; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 49 dBm (típico)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (típico); Ganho de potência 13 dB (típico); PAE 50 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2600; Máximo: 3700; Valor: 2600–3700; Unidade: MHz

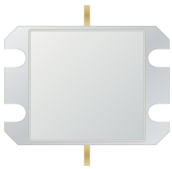
Potência de saída saturada: Mínimo: 48; Típico: 49; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 12; Típico: 13; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Mínimo: 45; Típico: 50; Unidade: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 51 dBm (típico)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (típico); Ganho de potência 9 dB (típico); PAE 38 % (típico).

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 8500; Máximo: 9600; Valor: 8500–9600; Unidade: MHz

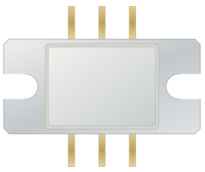
Potência de saída saturada: Mínimo: 50; Típico: 51; Unidade: dBm

Ganho de potência: Mínimo: 8; Típico: 9; Unidade: dB

Eficiência de potência adicionada: Típico: 38; Unidade: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6000 MHz; Potência de saída de referência 45.51 dBm (típico); Ganho de potência 19.51 dB (típico); Eficiência de dreno 39.82 % (típico) @ 6000 MHz.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6000; Valor: 2000–6000; Unidade: MHz

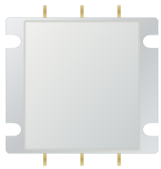
Potência de saída de referência: Típico: 45.51; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganho de potência: Típico: 19.51; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiência de dreno: Símbolo: ηD; Típico: 39.82; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (típico)

700–6200 MHz; Potência de saída saturada 49 dBm (típico); Ganho de potência 7 dB (típico); Eficiência de dreno 35 % (típico) @ 6000 MHz.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 700; Máximo: 6200; Valor: 700–6200; Unidade: MHz

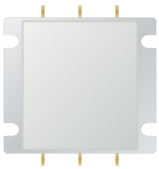
Potência de saída saturada: Símbolo: Psat; Típico: 49; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganho de potência: Típico: 7; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiência de dreno: Símbolo: ηD; Típico: 35; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Detalhes do produto Ficha técnica do produto



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Transistor de potência com casamento interno — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (típico)

2000–6200 MHz; Potência de saída de referência 50.1 dBm (típico); Ganho de potência 8.6 dB (típico); Eficiência de dreno 52.4 % (típico) @ 6000 MHz.

Frequência de operação: Símbolo: f; Mínimo: 2000; Máximo: 6200; Valor: 2000–6200; Unidade: MHz

Potência de saída de referência: Típico: 50.1; Unidade: dBm; Notas: f = 6000 MHz

Ganho de potência: Típico: 8.6; Unidade: dB; Notas: f = 6000 MHz

Eficiência de dreno: Símbolo: ηD; Típico: 52.4; Unidade: %; Notas: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Detalhes do produto Ficha técnica do produto

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.